## Series &RQPS/S

प्रश्न-पत्र कोड Q.P. Code

**55/S/3** 

रोल नं. Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



# भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे अधिकतम अंक : 70

Time allowed: 3 hours Maximum Marks: 70

NOTE

	नाट		NOTE
(1)	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ <b>27</b> हैं ।	(I)	Please check that this question paper contains <b>27</b> printed pages.
(II)	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।	(II)	Please check that this question paper contains <b>33</b> questions.
(III)	प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(III)	Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
/I\ /\		(1\/\	Diagon wells down the contain sumbon of
(IV)	कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(10)	Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.



### सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। **सभी** प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है **खण्ड क, ख, ग, घ** एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस अध्ययन-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, **खण्ड क** के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

जहाँ आवश्यक हो, आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं :

$$c=3\times10^8$$
 m/s  $h=6.63\times10^{-34}$  Js  $e=1.6\times10^{-19}$  C  $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$  T m  $A^{-1}$   $\epsilon_0=8.854\times10^{-12}$   $C^2$   $N^{-1}$  m $^{-2}$   $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}=9\times10^9$  N m $^2$  C $^{-2}$  इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान  $(m_e)=9.1\times10^{-31}$  kg प्रोटॉन का द्रव्यमान  $=1.675\times10^{-27}$  kg प्रोटॉन का द्रव्यमान  $=1.673\times10^{-27}$  kg आवोगाद्रो संख्या  $=6.023\times10^{23}$  प्रति ग्राम मोल बोल्ट्ज़मान नियतांक  $=1.38\times10^{-23}$  JK $^{-1}$ 

55/S/3 2



#### General Instructions:

Read the following instructions carefully and follow them:

- (i) This question paper contains 33 questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections **Sections** A, B, C, D and E.
- (iii) In **Section** A Questions no. 1 to 16 are Multiple Choice type questions. Each question carries 1 mark.
- (iv) In **Section B** Questions no. 17 to 21 are Very Short Answer type questions. Each question carries 2 marks.
- (v) In **Section C** Questions no. **22** to **28** are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) In **Section D** Questions no. **29** and **30** are case study-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) In **Section E** Questions no. **31** to **33** are Long Answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the Sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculators is **not** allowed.

 $You \ may \ use \ the \ following \ values \ of \ physical \ constants \ wherever \ necessary:$ 

$$\begin{split} c &= 3 \times 10^8 \text{ m/s} \\ h &= 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js} \\ e &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \\ \mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1} \\ \epsilon_0 &= 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} &= 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \end{split}$$

Mass of electron (m<sub>e</sub>) =  $9.1 \times 10^{-31}$  kg

Mass of neutron = 
$$1.675 \times 10^{-27}$$
 kg

Mass of proton = 
$$1.673 \times 10^{-27}$$
 kg

Avogadro's number =  $6.023 \times 10^{23}$  per gram mole

Boltzmann constant =  $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ 

55/S/3 3 P.T.O.



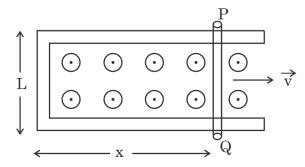
#### खण्ड क

1. किसी विद्युत-चुम्बकीय तरंग से संबद्ध विद्युत-क्षेत्र E को इस प्रकार निरूपित किया गया है :

$$E_{v} = E_{0} \sin(kx - \omega t)$$

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

- (A) तरंग +x-अक्ष के अनुदिश संचरण कर रहा है।
- (B) तरंग +z-अक्ष के अनुदिश संचरण कर रहा है।
- (C) तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र  $\xrightarrow{B}$  +y-अक्ष के अनुदिश कार्यरत है।
- (D) तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र  $\stackrel{\longrightarrow}{B}$  -x-अक्ष के अनुदिश कार्यरत है।
- 2. प्रतिरोधक  $100~\Omega$  तथा धारिता  $5~\mu F$  का कोई संधारित्र  $200~V,~\frac{1000}{\pi}~Hz$  के किसी ac स्रोत से संयोजित है। अनुप्रयुक्त वोल्टता (V) तथा धारा (I) के बीच कलान्तर है:
  - (A) 120°
- (B) 90°
- (C)  $60^{\circ}$
- (D) 45°
- ${f 3.} \qquad {f m, m_n}$  तथा  ${f m_p}$  क्रमश: नाभिक  ${f A \over Z} X$  , न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमानों का निरूपण करते हैं । तब :
  - (A)  $m < (A Z) m_n + Z m_n$
- (B)  $m = (A Z) m_n + Z m_p$
- (C)  $m = (A Z) m_p + Z m_n$
- (D)  $m > (A Z) m_n + Z m_p$
- **4.** आरेख में दर्शाए अनुसार प्रतिरोध R की कोई चालक छड़ PQ नियत एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र  $\overrightarrow{B}$  में स्थित किसी घर्षण-रहित चालक रेलों (पटरियों) पर रखी है। यह मानते हुए कि रेलों का प्रतिरोध उपेक्षणीय है, छड़ को नियत वेग  $\overrightarrow{v}$  से दाएँ खींचने के लिए आवश्यक बल होगा:



(A) 0

(B) Blv

(C)  $\frac{Blv}{R}$ 

(D)  $\frac{B^2 l^2 v}{R}$ 

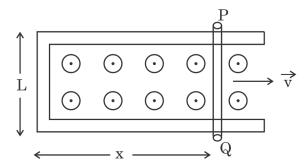
#### SECTION A

1. The electric field E associated with an electromagnetic wave is represented by

$$E_{y} = E_{0} \sin(kx - \omega t)$$

Which of the following statements is correct?

- (A) The wave is propagating along +x-axis.
- The wave is propagating along +z-axis. (B)
- The magnetic field  $\stackrel{\longrightarrow}{B}$  of the wave is acting along +y-axis. (C)
- The magnetic field  $\overrightarrow{B}$  of the wave is acting along -x-axis. (D)
- A capacitor of 5  $\mu$ F is connected to an ac source of 200 V,  $\frac{1000}{\pi}$  Hz through a 2. resistor of 100  $\Omega$ . The phase difference between the voltage (V) applied and current (I) is:
  - 120° (A)
- (B)
- (C) 60°
- (A)  $120^{\circ}$  (B)  $90^{\circ}$  (C)  $60^{\circ}$  (D)  $45^{\circ}$  m, m<sub>n</sub> and m<sub>p</sub> represents masses of  ${}^{A}_{Z}X$  nucleus, a neutron and a proton, **3.** respectively. Then:
  - $m < (A Z) m_n + Z m_n$ (A)
- (B)  $m = (A Z) m_n + Z m_n$
- (C)
- $m = (A Z) m_p + Z m_n$  (D)  $m > (A Z) m_n + Z m_p$
- A rod PQ of resistance R lies across frictionless conducting rails in a constant 4. uniform magnetic field  $\overrightarrow{B}$ , as shown in the figure. Assuming that the rails have negligible resistance, the force required to pull the rod to the right at constant velocity  $\overrightarrow{v}$  is:



0 (A)

Blv

(C)

55/S/3

5

**CLICK HERE** 

5.	जब कि पदार्थ :	सी लोह-चुम्बकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप तक गर्म किया जाता है, तो वह
	(A)	प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की भाँति व्यवहार करेगा।
	(B)	अनुचुम्बकीय पदार्थ की भाँति व्यवहार करेगा।
	(C)	स्थायी रूप से विचुम्बिकत हो जाएगा।
	(D)	लोह-चुम्बकीय ही रहेगा।

कोई बिन्दुकित बिम्ब वायु में दो माध्यमों, वायु और काँच को पृथक् करने वाली वक्रता त्रिज्या R के 6. उत्तल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर 4R दूरी पर स्थित है। जैसे-जैसे बिम्ब इस पृष्ठ की ओर गति करता है, इसका प्रतिबिम्ब :

- सदैव वास्तविक बनता है (A)
- सदैव आभासी बनता है (B)
- पहले आभासी और फिर वास्तविक बनता है (C)
- पहले वास्तविक और फिर आभासी बनता है (D)

1.5 cm लम्बे किसी तार से 5 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को 0.2 T के एकसमान चुम्बकीय 7. क्षेत्र में रखने पर इस पर 7.5 mN का बल कार्य करता है। चुम्बकीय क्षेत्र तथा तार से प्रवाहित धारा की दिशा के बीच का कोण है:

- (A) 30°
- (B)  $45^{\circ}$  (C)  $60^{\circ}$
- (D) 90°

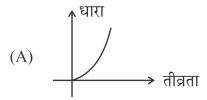
समान द्रव्यमान के दो कणों A और B, जिन पर क्रमश: आवेश q और 4q हैं, को दो विभिन्न 8. विभवान्तरों  ${
m V_A}$  और  ${
m V_B}$  द्वारा विराम स्थिति से इस प्रकार त्विरत किया गया है कि वे समान गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं।  $\left(rac{V_A}{V_B}
ight)$  का मान है :

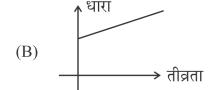
- (A)  $\frac{1}{4}$  (B)  $\frac{1}{2}$
- (C) 2
- (D) 4

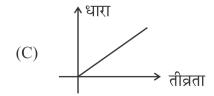
5.		a ferromagnetic substance is heated to a temperature above its Curie rature, it will:
	(A)	behave like a diamagnetic material.
	(B)	behave like a paramagnetic material.
	(C)	permanently demagnetise.
	(D)	remain a ferromagnetic.
_		

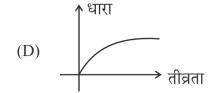
- 6. A point object is placed in air at a distance of 4R on the principal axis of a convex spherical surface of radius of curvature R separating two mediums, air and glass. As the object is moved towards the surface, the image formed is:
  - (A) always real
  - (B) always virtual
  - (C) first virtual and then real
  - (D) first real and then virtual
- 7. A current of 5 A is flowing in a wire of length 1.5 cm. A force of 7.5 mN acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 0.2 T. The angle between the magnetic field and the direction of current is:
  - (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°
- 8. Two particles A and B of the same mass but having charges q and 4q respectively, are accelerated from rest through different potential differences  $V_A$  and  $V_B$  such that they attain same kinetic energies. The value of  $\left(\frac{V_A}{V_B}\right)$  is :
  - (A)  $\frac{1}{4}$
- (B)
- (C) 2
- (D) 4

- 9. ऐल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
  - (A) प्रकीर्णन कोण  $\theta \approx 0$  के लिए, संघट्ट प्राचल कम होता है।
  - (B) प्रकीर्णन कोण  $\theta \simeq \pi$  के लिए, संघट्ट प्राचल अधिक होता है।
  - (C) प्रत्यक्ष (सम्मुख) संघट्ट करने वाले ऐल्फ़ा कणों की संख्या कम होती है।
  - (D) यह प्रयोग लक्ष्य परमाणु के साइज़ की ऊपरी सीमा का आकलन प्रदान करता है।
- 10. नीचे दिया गया कौन-सा ग्राफ आपितत विकिरणों की तीव्रता के साथ प्रकाश-विद्युत धारा के विचरण का सही निरूपण करता है, जबिक अन्य प्राचलों को स्थिर रखा गया है ?









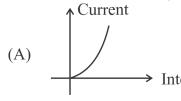
- 11. जब नैज सिलिकॉन अर्धचालक को Al परमाणु से मादित किया जाता है, तब :
  - (A) चालन बैंड में होलों की संख्या घट जाती है।
  - (B) संयोजकता बैंड में होलों की संख्या बढ़ जाती है।
  - (C) ऊर्जा अन्तराल का मान बढ़ जाता है।
  - (D) संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है।
- 12. दो सेल जिनके वि.वा. बल (emf) 2 V और 3 V तथा आन्तरिक प्रतिरोध क्रमश:  $1 \Omega$  और  $2 \Omega$  हैं, पार्श्व में संयोजित हैं। इस संयोजन सेल का प्रभावी वि.वा. बल (emf) तथा आन्तरिक प्रतिरोध क्रमश: होगा:
  - (A)  $3 \text{ V}, 1 \Omega$

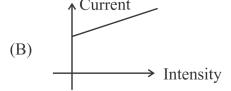
(B)  $5 \text{ V}, 3 \Omega$ 

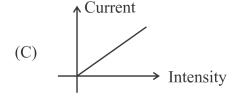
(C)  $\frac{7}{3}$  V,  $\frac{2}{3}$   $\Omega$ 

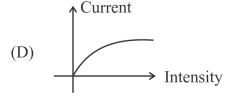
(D)  $\frac{6}{5}$  V,  $\frac{2}{3}$   $\Omega$ 

- **9.** Which of the following statements is correct for alpha particle scattering experiment?
  - (A) For angle of scattering  $\theta \approx 0$ , the impact parameter is small.
  - (B) For angle of scattering  $\theta = \pi$ , the impact parameter is large.
  - (C) The number of alpha particles undergoing head-on collision is small.
  - (D) The experiment provides an estimate of the upper limit to the size of target atom.
- 10. Which one of the given graphs correctly represents the variation of photoelectric current with the intensity of incident radiation, keeping other parameters fixed?









- 11. When intrinsic silicon semiconductor is doped with Al atom, then it:
  - (A) decreases the number of holes in the conduction band.
  - (B) increases the number of holes in the valence band.
  - (C) increases the energy gap value.
  - (D) increases the number of electrons in the valence band.
- 12. Two cells of emf 2 V and 3 V, and internal resistance 1  $\Omega$  and 2  $\Omega$ , respectively are connected in parallel. The effective emf and internal resistance of the combination cell are respectively:
  - (A)  $3 \text{ V}, 1 \Omega$

(B)  $5 \text{ V}, 3 \Omega$ 

(C)  $\frac{7}{3}$  V,  $\frac{2}{3}$   $\Omega$ 

(D)  $\frac{6}{5}$  V,  $\frac{2}{3}$   $\Omega$ 

प्रश्न संख्या 13 से 16 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या **नहीं** करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।
- (D) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों ग़लत हैं।
- 13. अभिकथन (A): यद्यपि गॉगल (धूप के चश्मे) लेंसों के पृष्ठ वक्रित होते हैं, परन्तु उनमें कोई क्षमता नहीं होती है।
  - कारण (R): गॉगलों के प्रकरण में दोनों वक्रित पृष्ठ एक ही ओर वक्रित होते हैं और इनकी वक्रता त्रिज्या समान होती है।
- 14. अभिकथन (A) : किसी चालक तार के किसी बिन्दु पर धारा घनत्व  $(\overrightarrow{J})$  उस बिन्दु पर विद्युत-क्षेत्र  $(\overrightarrow{E})$  की दिशा में होती है।
  - कारण (R): चालक तार ओम के नियम का पालन करता है।
- 15. अभिकथन (A): सूर्य में ऊर्जा जनन के लिए नाभिकीय विखण्डन अभिक्रियाएँ उत्तरदायी होती हैं।
  - कारण (R): नाभिकीय विखण्डन अभिक्रियाओं में हल्के नाभिक परस्पर मिलकर संलयित होते हैं।
- 16. अभिकथन (A): जब कोई धारावाही कुण्डली किसी त्रिज्य चुम्बकीय क्षेत्र में निलंबित होती है तब उस पर कार्यरत बल-आधूर्ण अधिकतम होता है।
  - कारण (R): बल-आघूर्ण की प्रवृत्ति कुण्डली को उसके अक्ष पर घूर्णन कराने की होती है। खण्ड ख
- 17. किसी संधि डायोड के लिए हासी स्तर और विभव रोधिका पदों की इनके निर्माण सहित व्याख्या कीजिए।
- 18. एक इलेक्ट्रॉन किसी क्षेत्र से गुज़र रहा है तथा वह किसी बल का अनुभव नहीं कर रहा है। यह किस पिरिस्थिति में संभव हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र से गुजरे जहाँ (a) केवल चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है, और (b) विद्युत और चुम्बकीय दोनों क्षेत्र विद्यमान हों ? अपने उत्तरों की पृष्टि कीजिए।

55/S/3 10

2

Questions number 13 to 16 are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is *not* the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.
- **13.** Assertion (A): Although the surfaces of a goggle lens are curved, it does not have any power.
  - Reason (R): In case of goggles, both the curved surfaces are curved on the same side and have equal radii of curvature.
- 14. Assertion (A): The current density  $(\overrightarrow{J})$  at a point in a conducting wire is in the direction of electric field  $(\overrightarrow{E})$  at that point.
  - Reason (R): A conducting wire obeys Ohm's law.
- **15.** Assertion (A): Nuclear fission reactions are responsible for energy generation in the Sun.
  - Reason (R): Light nuclei fuse together in the nuclear fission reactions.
- **16.** Assertion (A): The torque acting on a current carrying coil is maximum when it is suspended in a radial magnetic field.
  - Reason(R): The torque tends to rotate the coil on its own axis.

#### **SECTION B**

- 17. Explain the terms depletion layer and potential barrier for a junction diode and their formation.
- 18. An electron is passing through a region and experiences no force. Under what condition is it possible when the region has (a) only the magnetic field, and (b) both the electric and the magnetic fields? Justify your answers.

55/S/3 11 P.T.O.

2

- 19. (a)  $12~\Omega$  के बाह्य प्रतिरोध के सिरों से संयोजित कोई सेल  $0.25~\Lambda$  धारा की आपूर्ति कर रहा है। बाह्य प्रतिरोध में  $4~\Omega$  की वृद्धि करने पर धारा घटकर  $0.2~\Lambda$  हो जाती है। सेल का
  - (i) वि.वा. बल (emf), तथा (ii) आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

#### अथव

(b) 3 μC और 4 μC के दो बिन्दु आवेश x-y तल में (0·3 m, 0) तथा (0, 0.3 m) पर वायु में स्थित हैं । मूल-बिन्दु (0, 0) पर उत्पन्न नेट विद्युत-क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए।

2

- 20. एक बिन्दुकित प्रकाश स्रोत किसी बाल्टी की तली, जिसमें 10 cm ऊँचाई तक μ = 1.25 (अपवर्तनांक) का कोई द्रव भरा है, पर रखा है। परिकलित कीजिए :
  - (a) द्रव-वायु अन्तरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण
  - (b) द्रव के पृष्ठ से निर्गत प्रकाश स्रोत द्वारा बनाए गए वृत्ताकार चमकीले भाग की त्रिज्या

2

2

21. हाइगेन्स का सिद्धान्त लिखिए। इसका उपयोग करके किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली समतल तरंग के गमन पथ का चित्र विस्तार से दर्शाइए।

#### п

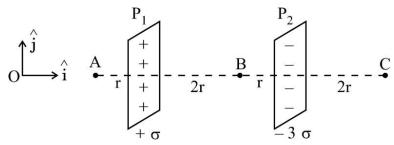
22. (a) किसी चालक तार AB, जिसकी त्रिज्या उसके एक सिरे A से दूसरे सिरे B तक एकसमान रूप से घट रही है, किसी बैटरी के सिरों से संयोजित है। इस तार में सिरे A से सिरे B तक (i) विद्युत-क्षेत्र, (ii) धारा घनत्व, तथा (iii) इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किस प्रकार परिवर्तित होगी? प्रत्येक प्रकरण में अपने उत्तर की पृष्टि कीजिए।

3

#### अथवा

(b) आरेख में दर्शाए अनुसार दो बड़े समतल चादर  $P_1$  और  $P_2$ , जिनके आवेश घनत्व क्रमश: +  $\sigma$  और - 3  $\sigma$   $\stackrel{?}{\epsilon}$ , एक दूसरे के समान्तर स्थित हैं । बिन्दुओं A, B और C पर नेट विद्युत-क्षेत्र  $(\overrightarrow{E})$  ज्ञात कीजिए।

3



55/S/3

12

CLICK HERE



19. (a) A cell is connected across an external resistance 12  $\Omega$  and supplies 0.25 A current. When the external resistance is increased by 4  $\Omega$ , the current reduces to 0.2 A. Calculate (i) the emf, and (ii) the internal resistance, of the cell.

2

#### OR

(b) Two point charges of 3  $\mu$ C and 4  $\mu$ C are kept in air at (0·3 m, 0) and (0, 0.3 m) in x-y plane. Find the magnitude and direction of the net electric field produced at the origin (0, 0).

2

- 20. A point light source rests on the bottom of a bucket filled with a liquid of refractive index  $\mu = 1.25$  up to height of 10 cm. Calculate:
  - (a) the critical angle for liquid-air interface
  - (b) radius of circular light patch formed on the surface by light emerging from the source.

2

21. State Huygens principle. Using it draw a diagram showing the details of passage of a plane wave from a denser into a rarer medium.

2

#### **SECTION C**

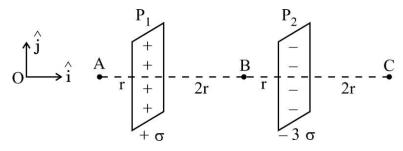
22. (a) The radius of a conducting wire AB uniformly decreases from its one end A to another end B. It is connected across a battery. How will (i) electric field, (ii) current density, and (iii) mobility of electrons change from end A to end B? Justify your answer in each case.

3

#### OR

(b) Two large plane sheets  $P_1$  and  $P_2$  having charge densities  $+ \sigma$  and  $- 3 \sigma$  respectively are arranged parallel to each other as shown in the figure. Find the net electric field  $(\overrightarrow{E})$  at points A, B and C.

3



55/S/3 13 P.T.O.

23.	$10~\mu C$ और $20~\mu C$ के दो बिन्दु आवेश $E=rac{A}{r^2}$ विद्युत-क्षेत्र के प्रदेश में बिन्दुओं ( $-4~cm,0,0$ )
	तथा (5 cm, 0, 0) पर स्थित हैं, जहाँ $A=2\times 10^6~NC^{-1}~m^2$ तथा $\overrightarrow{r}$ विचारणीय बिन्दु पर
	स्थिति सदिश है। इस निकाय की स्थिर-वैद्यत स्थितिज ऊर्जा परिकलित कीजिए।

24. उचित कारण देते हुए निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

- 3
- (a) किसी संधारित्र को आवेशित करने की अवधि में, संधारित्र में विस्थापन धारा विद्यमान होती है। परन्तु संधारित्र के पूर्णत: आवेशित होने के पश्चात कोई विस्थापन धारा नहीं होती है।
- (b) माइक्रोवेव ऑवन में सूक्ष्मतरंगों की आवृत्ति का मिलान जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति से होता है।
- (c) अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगें भी कहते हैं।
- **25.** देहली आवृत्ति  $1.0 \times 10^{15}$  Hz के किसी प्रकाश-सुग्राही पृष्ठ पर  $3.0 \times 10^{15}$  Hz आवृत्ति के विकरण आपतन करते हैं। परिकलित कीजिए :
  - (a) पृष्ठ का कार्यफलन
  - (b) प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा
- 26.  $\frac{6}{\pi}$  cm<sup>2</sup> क्षेत्रफल का कोई लघु वृत्ताकार पाश किसी लम्बी परिनालिका के भीतर उसके केन्द्र पर इस प्रकार स्थित है कि पाश का अक्ष परिनालिका के अक्ष से 60° का कोण बनाता है। परिनालिका में फेरों की संख्या 10 फेरे प्रति सेन्टीमीटर है। परिनालिका में धारा में एकसमान परिवर्तन 5 A से शून्य तक 10 ms में किया गया है। पाश में प्रेरित वि.वा. बल (emf) परिकलित कीजिए।
- 3

- 27. ac वोल्टता  $v = v_0 \sin \omega t$  के किसी स्रोत से बारी-बारी से किसी आदर्श प्रतिरोधक R, किसी आदर्श प्रेरक L तथा किसी आदर्श संधारित्र C को संयोजित किया गया है। प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रत्येक प्रकरण में परिपथ में समान धारा I प्रवाहित होती है।
  - (a) यदि इनके श्रेणी संयोजन को इसी स्रोत से संयोजित किया जाए, तो परिपथ में प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान क्या होगा?
  - (b) प्रत्येक प्रकरण में धारा पर स्रोत आवृत्ति में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? अपने उत्तरों की पृष्टि कीजिए।

- 3
- **28.** (a) एकल झिरी पर विवर्तन के कारण फ्रिन्जों के तीव्रता वितरण वक्र की आकृति खींचिए।
  - (b) सम्पर्क में समाक्ष रखे दो लेंसों के संयोजन की क्षमता के लिए संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

- Two point charges of 10  $\mu$ C and 20  $\mu$ C are located at points (– 4 cm, 0, 0) and (5 cm, 0, 0) respectively, in a region with electric field  $E = \frac{A}{r^2}$ , where  $A = 2 \times 10^6 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$  and  $\overrightarrow{r}$  is the position vector of the point under consideration. Calculate the electrostatic potential energy of the system.
- 3

**24.** Explain the following, giving proper reason :

- 3
- (a) During charging of a capacitor, displacement current exists in the capacitor. But there is no displacement current when it gets fully charged.
- (b) The frequency of microwaves in ovens matches with the resonant frequency of water molecules.
- (c) Infrared waves are also known as heat waves.
- 25. Radiations of frequency  $3.0 \times 10^{15}$  Hz are incident on a photosensitive surface of threshold frequency  $1.0 \times 10^{15}$  Hz. Calculate :
  - (a) work function of the surface
  - (b) maximum kinetic energy of photoelectrons
- 26. A small circular loop of area  $\frac{6}{\pi}$  cm<sup>2</sup> is placed inside a long solenoid at its centre such that its axis makes an angle of 60° with the axis of the solenoid. The number of turns per cm is 10 in the solenoid. The current in the solenoid changes uniformly from 5 A to zero in 10 ms. Calculate the emf induced in the loop.
- 3

3

- 27. An ideal resistor R, an ideal inductor L and an ideal capacitor C are connected, one by one, across the same source of ac voltage  $v = v_0 \sin \omega t$ . It is observed that the same current I flows in each case.
  - (a) What will be the instantaneous value of current that will flow through their series combination when connected across the same source?
  - (b) How will the current in each case be affected if the frequency of the source is increased?

Justify your answers.

3

- **28.** (a) Draw the shape of intensity distribution curve of the fringes due to diffraction at a single slit.
  - (b) Derive the relation for the power of combination of two lenses placed in contact co-axially.

**CLICK HERE** 

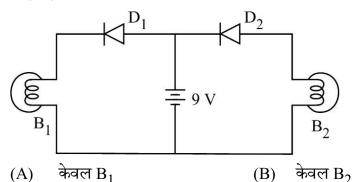
3

P.T.O.

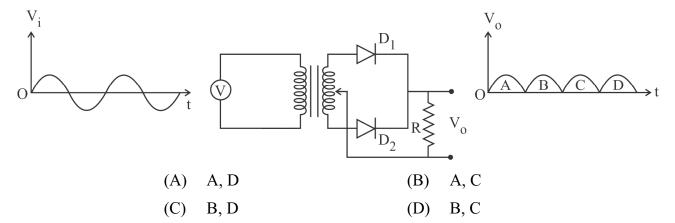
55/S/3 15

प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस अध्ययन-आधारित प्रश्न हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- ac को dc में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को करने वाली युक्ति 29. को दिष्टकारी कहते हैं। जब किसी संधि डायोड पर कोई ac सिग्नल धनात्मक अर्धचक्र पर लगता है तो वह डायोड अग्रदिशिक बायसित हो जाता है तथा उससे धारा प्रवाहित होती है। ऋणात्मक अर्धचक्र की अवधि में, डायोड पश्चदिशिक बायसित हो जाता है और उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार ac सिग्नल का दिष्टकरण हो जाता है। p-n संधि डायोडों का उपयोग अर्ध-तरंग दिष्टकारी और पूर्ण-तरंग दिष्टकारी के रूप में किया जा सकता है।
  - दिए गए परिपथ में कौन-सा/से बल्ब चमकेगा/चमकेंगे ? (i)



- $B_1$  और  $B_2$  दोनों (C)
- न तो  $B_1$  और न ही  $B_2$ (D)
- आरेख में पूर्ण-तरंग दिष्टकारी परिपथ दर्शाया गया है। निर्गत तरंगरूप में संधि डायोड (ii) (a)  $D_1$  का योगदान है:



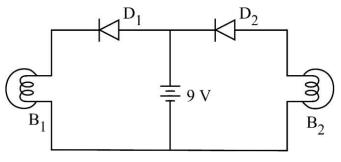
अथवा

1

#### **SECTION D**

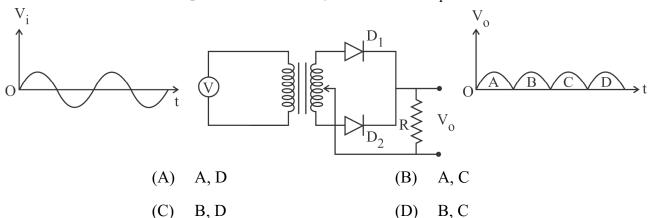
Questions number 29 and 30 are case study-based questions. Read the following paragraphs and answer the questions that follow.

- 29. The process of converting ac into dc is called rectification and the device used is called a rectifier. When ac signal is fed to a junction diode during positive half cycle, the diode is forward biased and current flows through it. During the negative half cycle, the diode is reverse biased and it does not conduct. Thus the ac signal is rectified. The p-n junction diodes can be used as half-wave and full-wave rectifiers.
  - (i) Which bulb/bulbs will glow in the given circuit?



(A) B<sub>1</sub> only

- (B) B<sub>2</sub> only
- (C) Both  $B_1$  and  $B_2$
- (D) Neither B<sub>1</sub> nor B<sub>2</sub>
- (ii) (a) A full-wave rectifier circuit is shown in the figure. The contribution in output waveform from junction diode  $D_1$  is :



OR

55/S/3 17 P.T.O.



1

- (b) किसी अर्ध-तरंग दिष्टकारी का निर्गत होता है :
  - (A) बिना उर्मिका का एकदिशिक
- (B) स्थायी और सतत
- (C) उर्मिका के साथ एकदिशिक
- (D) स्थायी और असतत

1

1

1

- (iii) p-n संधि डायोड में p-फलक पर और n-फलक पर बहुसंख्यक आवेश क्रमश: होते हैं :
  - (A) इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन

(B) इलेक्ट्रॉन, होल

(C) होल, होल

- (D) होल, इलेक्ट्रॉन
- (iv) यदि अर्ध-तरंग दिष्टकारी की आवृत्ति 50 Hz है, तो पूर्ण-तरंग दिष्टकारी की आवृत्ति होगी :
  - (A) 25 Hz

(B) 50 Hz

(C) 100 Hz

- (D) 200 Hz
- 30. द्विध्रुवों की, चाहे वह वैद्युतीय हों अथवा चुम्बकीय, अभिलाक्षणिक विशेषता उनके द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, जो सदिश राशियाँ हैं। लघु दूरी द्वारा पृथिकत दो समान और विजातीय आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जबिक कोई धारावाही पाश चुम्बकीय द्विध्रुव की भाँति व्यवहार करता है। विद्युत द्विध्रुव अपने चारों ओर विद्युत-क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। किसी बाह्य विद्युत-क्षेत्र में स्थित किए जाने पर विद्युत द्विध्रुव बल-आधूर्ण का अनुभव करते हैं।
  - (i) दो सर्वसम विद्युत द्विध्रुवों को, जिनमें प्रत्येक द्विध्रुव दूरी d द्वारा पृथिकत दो आवेशों q और + q से बना है, x-y तल में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इनके ऋणावेश मूल-बिन्दु
     O पर हैं तथा धनावेश क्रमश: बिन्दुओं (d, 0) और (0, d) पर स्थित हैं। इस निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण है:
    - (A)  $-qd(\hat{i}+\hat{j})$

(B)  $q d (\mathring{i} + \mathring{j})$ 

(C)  $q d(\hat{i} - \hat{j})$ 

(D)  $q d (\hat{j} - \hat{i})$ 

55/S/3

- (b) The output in a half-wave rectifier is:
  - unidirectional without ripple (B) steady and continuous
  - (C) unidirectional with ripple
- (D) steady but discontinuous

1

1

- In a p-n junction diode, the majority charge carriers on p-side and on (iii) n-side are, respectively:
  - (A) electrons, electrons
- (B) electrons, holes

(C) holes, holes

(A)

- (D) holes, electrons
- If the frequency of the half-wave rectifier is 50 Hz, the frequency of (iv) full-wave rectifier is:
  - (A) 25 Hz

(B) 50 Hz

(C) 100 Hz

- (D) 200 Hz
- **30.** Dipoles, whether electric or magnetic, are characterised by their dipole moments, which are vector quantities. Two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole, while a current carrying loop behaves as a magnetic dipole. Electric dipoles create electric fields around them. Electric dipoles experience a torque when placed in an external electric field.
  - Two identical electric dipoles, each consisting of charges -q and +q(i) separated by distance d, are arranged in x-y plane such that their negative charges lie at the origin O and positive charges lie at points (d, 0) and (0, d) respectively. The net dipole moment of the system is :

**CLICK HERE** 

(A)  $-q d(\hat{i} + \hat{j})$ 

(B)  $q d (\mathring{i} + \mathring{j})$ 

(C)  $qd(\hat{i} - \hat{j})$ 

(D)  $q d (\hat{j} - \hat{i})$ 

55/S/3 19

- 2a दूरी से पृथिकत तथा -q और +q आवेशों के बने किसी द्विध्नव के कारण दूरी (ii) r >> a) के (1) किसी बिन्दु जो उसके अक्ष पर स्थित है, तथा (2) किसी बिन्दु जो विषुवतीय
  - तल पर स्थित है, पर विद्युत-क्षेत्र के परिमाण क्रमशः  $E_1$  और  $E_2$  हैं। तब  $\left(\frac{E_1}{E_2}\right)$  है :
  - (A)  $\frac{1}{4}$  (B)  $\frac{1}{2}$  (C) 2
- (D) 4

1

1

1

- $5.0 \times 10^{-8} \ \mathrm{Cm}$  द्विध्रुव आधूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे प्रदेश में रखा है जहाँ किसी (iii) दिए गए क्षण पर विद्युत-क्षेत्र का परिमाण  $1.0 \times 10^3~{
  m N/C}$  है। इस क्षण पर विद्युत-क्षेत्र  $\overrightarrow{{
  m E}}$ का द्विध्रुव आधूर्ण  $\overrightarrow{P}$  से झुकाव 30° है। इस क्षण द्विध्रुव पर कार्यरत बल-आधूर्ण का परिमाण है :
  - $2.5 \times 10^{-5} \text{ Nm}$ (A)
- (B)  $5.0 \times 10^{-5} \text{ Nm}$
- (C)  $1.0 \times 10^{-4} \text{ Nm}$
- (D)  $2.0 \times 10^{-6} \text{ Nm}$
- हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के चारों ओर चाल v से त्रिज्या r (iv) (a) की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है:
  - (A) 4 evr

(B) 2 evr

(C)  $\frac{1}{2}$  evr

#### अथवा

- भुजा 5.0 cm के वर्गाकार पाश से 2.0 A की धारा प्रवाहित हो रही है। इस पाश से (b) संबद्ध चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है :
  - $1.0 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$ (A)
- (B)  $5.0 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$
- (C)  $1.0 \times 10^{-2} \text{ Am}^2$
- (D)  $5.0 \times 10^{-2} \text{ Am}^2$

55/S/3

- ${\rm E}_1$  and  ${\rm E}_2$  are magnitudes of electric field due to a dipole, consisting of (ii) charges -q and +q separated by distance 2a, at points r (>> a) (1) on its axis, and (2) on equatorial plane, respectively. Then  $\left(\frac{E_1}{E_2}\right)$  is :
- (B)  $\frac{1}{2}$  (C) 2
- An electric dipole of dipole moment  $5.0 \times 10^{-8}$  Cm is placed in a region (iii) where an electric field of magnitude  $1.0 \times 10^3$  N/C acts at a given instant. At that instant the electric field  $\overrightarrow{E}$  is inclined at an angle of 30° to dipole moment  $\overrightarrow{P}$ . The magnitude of torque acting on the dipole, at that instant is:
  - $2.5 \times 10^{-5} \text{ Nm}$ (A)
- (B)  $5.0 \times 10^{-5} \text{ Nm}$
- $1.0 \times 10^{-4} \text{ Nm}$ (C)
- (D)  $2.0 \times 10^{-6} \text{ Nm}$
- (iv) An electron is revolving with speed v around the proton in a (a) hydrogen atom, in a circular orbit of radius r. The magnitude of magnetic dipole moment of the electron is:
  - (A) 4 evr

(C)  $\frac{1}{2}$  evr

(D)  $\frac{1}{4}$  evr

OR

- (b) A square loop of side 5.0 cm carries a current of 2.0 A. The magnitude of magnetic dipole moment associated with the loop is:
  - $1.0 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$ (A)
- (B)  $5.0 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$
- $1.0 \times 10^{-2} \text{ Am}^2$ (C)
- (D)  $5.0 \times 10^{-2} \text{ Am}^2$

1

1

1

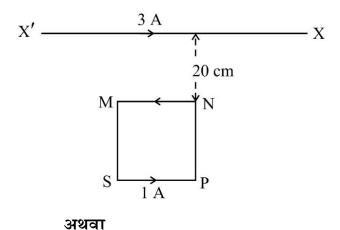
P.T.O.

1

www.studentbro.in

#### खण्ड ङ

- 31. (a) (i) नामांकित आरेख की सहायता से किसी ac जिनत्र की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। किसी क्षण 't' पर प्रेरित वि.वा.बल (emf) के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
  - (ii) कोई लम्बा, सीधा क्षैतिज तार X'X स्थिर रखा है तथा इससे 3.0 A धारा प्रवाहित हो रही है। आरेख में दर्शाए अनुसार इस तार X'X के पास कोई वर्गाकार पाश MNPS, जिसकी भुजा की लम्बाई 10 cm है तथा जिससे 1.0 A धारा प्रवाहित हो रही है, रखा है। इस तार के कारण पाश पर लगने वाले नेट चुम्बकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए।

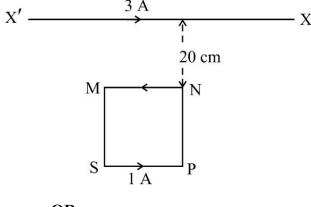


- (b) (i) फैराडे के विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा लेंज़ के नियम का उपयोग लिखिए। किसी कुण्डली के स्व-प्रेरकत्व के लिए उसकी ज्यामितीय संरचना तथा माध्यम की चुम्बकशीलता के पदों में व्यंजक प्राप्त कीजिए।
  - (ii) किसी 220~V की परिवर्ती आवृत्ति की ac आपूर्ति के साथ श्रेणी में एक  $20~\Omega$  का प्रतिरोध,  $80~\mu F$  का संधारित्र तथा 50~mH का प्रेरक संयोजित हैं। जब आपूर्ति की आवृत्ति इस परिपथ की मूल (प्राकृतिक) आवृत्ति के बराबर है, तो परिकलित कीजिए:
    - (1) आपूर्ति की कोणीय आवृत्ति
    - (2) परिपथ की प्रतिबाधा

5

#### **SECTION E**

- 31. (a) (i) With the help of a labelled diagram, explain the working of an ac generator. Obtain the expression for the emf induced at an instant 't'.
  - (ii) A long, straight horizontal wire X'X is held stationary and carries a current of 3.0 A. A square loop MNPS of side 10 cm, carrying a current of 1.0 A is kept near the wire X'X as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic force acting on the loop due to the wire.



- OR
- (b) State Faraday's law of electromagnetic induction and mention the utility of Lenz's law. Obtain an expression for self-inductance of a coil in terms of its geometry and permeability of the medium.
  - (ii) A resistance of  $20~\Omega$ , a capacitance of  $80~\mu F$  and an inductor of 50~mH are connected in series. This combination is connected across a 220~V ac supply of variable frequency. When the frequency of supply equals the natural frequency of the circuit, calculate:
    - (1) angular frequency of supply
    - (2) impedance of the circuit

5

P.T.O.

5

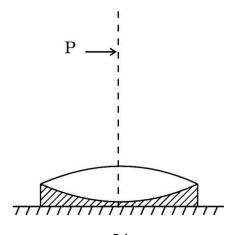
55/S/3



- 32. (a) (i) किसी खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक तथा अभिनेत्र लेन्सों की अभिकल्पना करते समय किन दो मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है ? किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता के लिए उस स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए जब अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है।
  - (ii) कोई प्रकाश किरण किसी समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज़्म के एक फलक पर 45° के कोण पर आपतन करती है और प्रिज़्म से सममितत: गुज़र जाती है। परिकलित कीजिए:
    - (1) प्रिज़्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण
    - (2) प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक

#### अथवा

- (b) (i) एकल झिरी के विवर्तन पैटर्न के प्रेक्षण के लिए किसी सरल क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।
  - (ii) नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए अनुसार कोई समोत्तल लेंस (अपवर्तनांक 1.50) किसी समतल दर्पण के फलक पर किसी द्रव की परत के सम्पर्क में रखा है। कोई छोटी सुई जिसकी नोक लेंस के मुख्य अक्ष पर है, अक्ष के अनुदिश ऊपर-नीचे गित कराकर इस प्रकार समायोजित की जाती है कि सुई की नोक का उल्टा प्रतिबिम्ब सुई की स्थित पर ही बने। लेंस से सुई की दूरी मापने पर 45.0 cm पाई जाती है। जब द्रव को हटाकर इसी प्रयोग को दुबारा किया जाता है, तो नई दूरी 30.0 cm पाई जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।



55/S/3

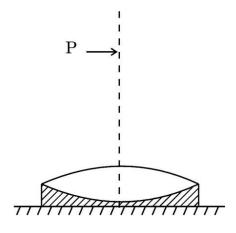
CLICK HERE

5

- 32. (a) (i) What are the two main considerations for designing the objective and eyepiece lenses of an astronomical telescope? Obtain the expression for magnifying power of the telescope when the final image is formed at infinity.
  - (ii) A ray of light is incident at an angle of 45° at one face of an equilateral triangular prism and passes symmetrically through the prism. Calculate:
    - (1) the angle of deviation produced by the prism
    - (2) the refractive index of the material of the prism

#### OR

- (b) (i) Describe a simple activity to observe diffraction pattern due to a single slit.
  - (ii) The figure below shows an equiconvex lens (of refractive index 1.50) in contact with a liquid layer on top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45.0 cm. When the liquid is removed and the experiment is repeated, the new distance is 30.0 cm. Find the refractive index of the liquid.



55/S/3 25 P.T.O.



5

- द्रव्य तरंगें किन्हें कहते हैं ? द्रव्यमान m तथा आवेश q के किसी कण को किसी 33. (i) (a) विभवान्तर V द्वारा विराम से त्वरित किया गया है। इस कण से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
  - $3.315 \, \mathrm{mW}$  निर्गत शक्ति के किसी स्रोत द्वारा  $5.0 \, imes 10^{14} \, \mathrm{Hz}$  आवृत्ति का (ii) एकवर्णी प्रकाश उत्पन्न किया गया है। परिकलित कीजिए:
    - इस प्रकाश पुन्ज में फ़ोटॉन की ऊर्जा **(1)**
    - स्रोत द्वारा प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फ़ोटॉनों की संख्या **(2)**

#### अथवा

- बोर के अभिगृहीतों का उल्लेख कीजिए तथा हाइड्रोजन परमाणु के बोर के मॉडल में (b) (i) nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
  - $^{-12}_{\phantom{0}6}{
    m C}$  की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा का (MeV में) परिकलन कीजिए। 5 (ii) दिया गया है :

$$m\binom{12}{6}C = 12.000000 u$$

$$m \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1.008665 u$$

$$m \binom{1}{1}H = 1.007825 u$$

55/S/3

26



- 33. (a) (i) What are matter waves? A particle of mass m and charge q is accelerated from rest through a potential difference V. Obtain an expression for de Broglie wavelength associated with the particle.
  - (ii) Monochromatic light of frequency  $5.0 \times 10^{14}$  Hz is produced by a source of power output 3.315 mW. Calculate :
    - (1) energy of the photon in the beam
    - (2) number of photons emitted per second by the source

      OR
  - (b) (i) State Bohr's postulates and derive an expression for the energy of electron in n<sup>th</sup> orbit in Bohr's model of hydrogen atom.
    - (ii) Calculate binding energy per nucleon (in MeV) of  ${}^{12}_{6}$ C.

Given:

$$m\left(\begin{array}{c} 12 \\ 6 \end{array}\right) = 12.000000 \ u$$

$$m \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1.008665 u$$

$$m \binom{1}{1}H = 1.007825 u$$

55/S/3 27



5

## Marking Scheme Strictly Confidential

## (For Internal and Restricted use only) Senior School Certificate Examination,2024

## **SUBJECT NAME PHYSICS [PAPER CODE 55/S/3]**

<b>General Instructions: -</b>	•
--------------------------------	---

You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct
assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems
which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To
avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand
the spot evaluation guidelines carefully.
"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the
examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to
public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the
life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action
under various rules of the Board and IPC."
Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not
be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme
should be strictly adhered to and religiously followed. <b>However, while evaluating, answers</b>
which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be
assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-
X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given
answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is
enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
The Marking scheme carries only suggested value points for the answers
These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The
students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should
be awarded accordingly.
The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator
on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given
in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration
and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after
ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.  Evaluators will mark( $\sqrt{}$ ) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be
1
marked. Evaluators will not put right ( $\checkmark$ )while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which
evaluators are committing.
If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks
awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-
hand margin and encircled. This may be followed strictly.
If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and
encircled. This may also be followed strictly.
If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks
should be retained and the other answer scored out with a note "Extra Question".
No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only
once.
A full scale of marks 0-70 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question
Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours
every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per







	day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced
	syllabus and number of questions in question paper.
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the
	Examiner in the past:-
	<ul> <li>Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.</li> </ul>
	Giving more marks for an answer than assigned to it.
	Wrong totaling of marks awarded on an answer.
	• Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
	Wrong question wise totaling on the title page.
	Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
	Wrong grand total.
	Marks in words and figures not tallying/not same.
	Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
	• Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is
	correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for
	incorrect answer.)
	Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be
	marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.
15	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error
	detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the
	evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned,
	it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for
	spot Evaluation" before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to
	the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment
	of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head
	Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out
	strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.



	MARKING SCHEME: PHYSICS(042)  Code: 55/S/3		
Q. No.	VALUE POINTS/EXPECTED ANSWERS	Marks	Total Marks
	SECTION A		
1.	(A) तरंग +X- अक्ष के अन्दिश संचरण कर रही है  .	1	1
2.	(D) 45°	1	1
3.	(A) $M < (A-Z) m_n + Z m_p$	1	1
4.	(D) $\frac{B^2 l^2 v}{R}$	1	1
5.	(B) अन्च्म्बकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा	1	1
6.	(D) पहले वास्तविक और फिर आभासी बनता है  .	1	1
7.	(A) 30°	1	1
8.	(D) 4	1	1
9.	(C) प्रत्यक्ष (सम्मुख) संघट्ट करने वाले ऐल्फा कणों की संख्या कम होती है।	1	1
10.	(C)धारा तीव्रता	1	1
11.	(B) संयोजकता बैण्ड में होलों की संख्या बढ़ जाती है	1	1
12.	$(C)\frac{7}{3}V,\frac{2}{3}\Omega$	1	1
13.	(A) अभिकथन(A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है	1	1
14.	(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परन्तु कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है	1	1
15.	(D) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं	1	1
16.	(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परन्तु कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है	1	1
	SECTION B		
17.	नीचे दिए गए पदों की निर्माण सिहत व्याख्या हासी स्तर 1 रोधिका विभव 1  • p-n संधि के निर्माण की अविधि में तथा p-एवंn- फलकों के		
	सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण होल p-फलक n-फलक की ओर विसरित होते हैं जिसके कारण वह अपने पीछे निश्चल आयनित	1	

गाही (ऋणावेश) छोड़ देते हैं ,इस प्रकार संधि के p-फलक पर ऋणावेश की ( या ऋणादकर रयेस-चार्ज क्षेत्र ) एक परत विकसित हो जाती है जो निश्चल होती है   इसी प्रकार $n$ - फलक पर घनावेश की परत विकसित हो जाती है   यह स्पेस चार्ज क्षेत्र संधि के दोनों और विकसित होता है   संधि के दोनों फलकों विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी स्तर कहते हैं    • संधि के $n$ - फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों पर कोई विभवान्तर विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.    18.    18.     जीदे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त ( ) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2}$ $\frac{1}$				
कृणावेश की ( या कृणात्मक रघेस-चार्ज क्षेत्र ) एक परत विकसित हो जाती है जो लिश्चल होती है   इसी प्रकार n- फलक पर घनावेश की परत विकसित हो जाती है   यह स्पेस चार्ज क्षेत्र संधि के दोनों और विकसित होता है   संधि के दोनों फलकों विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र के हासी स्तर कहते हैं    • संधि के n- फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों पर कोई विक्षवाल्पर विकसित हो जाता है लिरोधी विक्षव अथवा विक्षव प्राचीर कहते हैं    18.    जीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विदयुत एवं चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तव उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qv S \sin \theta$ $3 \sin F = 0$ . $3 \sin \theta = \theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शृल्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विदयुत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रांसित क्षेत्र में गित करता है   $3 \sin F_E + F_B = 0$ $3 \cos F_E + F_B = 0$		ग्राही (ऋणावेश) छोड़ देते हैं ,इस प्रकार संधि के p-फलक पर		
हो जाती है जो निश्चल होती है   इसी प्रकार n- फलक पर घनावेश की परत विकसित हो जाती है   यह स्पेस चार्ज क्षेत्र संधि के दोनों ओर विकसित होता है   संधि के दोनों फलकों विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी स्तर कहते हैं    • संधि के n- फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों पर कोई विक्षेत्राव्यार विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.  नीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ (b) जब विदयुत एवं चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB\sin\theta$ अतः $F = 0$ . जब $\theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विदयुत तथा चुम्बकीय क्षेत्र के क्रासित क्षेत्र में गित करता है    जब $F_x + F_y = 0$ $v = \frac{E}{B}$ 2  19 (a)  (i) सेल के emf का परिकलन   1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन   1 (ii) सेल के ज्ञांतरिक प्रतिरोध का परिकलन   1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन   1 (ii) सेल के ज्ञांतरिक प्रतिकलन   1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन   1 (ii) सेल के ज्ञ		ऋणावेश की ( या ऋणात्मक रचेस-चार्ज क्षेत्र ) एक परत विकसित		
धनावेश की परत विकसित हो जाती है   यह स्पेस चार्ज क्षेत्र संधि के दोनों ओर विकसित होता है   संधि के दोनों फलकों विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी स्तर कहते हैं    • संधि के $n$ - फलक पर धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों पर कोई विभवान्तर विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.    18.		,		
के दोनों और विकसित होता है   संधि के दोनों फलकों विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी स्तर कहते हैं    • संधि के $n$ - फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों पर कोई विअवान्तर विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.    18.   जीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0$ , जब $\theta = 0^\circ$ , $\theta = 180^\circ$ (b) बल तब शृन्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2} = \frac{E}{B}$ 19 (a)  (i) सेल के लाभ का परिकलन 1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (ii) सेल के $\frac{E}{B}$		_		
इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी स्तर कहते हैं   • संधि के n- फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों पर कोई विभवान्तर विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.    18.				
• साँधि के $n$ - फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के साँधि के सिरों पर कोई विभवान्तर विकित्तत हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.    जीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi$ : $F = 0$ , $3\pi$ $\theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\pi$ $\pi$ $\overline{F_e} + \overline{F_g} = 0$ $\pi$				
पर कोई विभवान्तर विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा विभव प्राचीर कहते हैं    18.  जींचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन िकसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi c$ : $F = 0$ , $3\pi c$ $\theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नींचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रांसित क्षेत्र में गित करता है   $3\pi c$ $F_E + F_B = 0$		इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी स्तर कहते हैं		
विभव प्राचीर कहते हैं    18.  बीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन िकसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi c$ ; $F = 0$ , $3\pi a$ $\theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $3\pi a$ $F_E + F_B = 0$ $3\pi $		<ul> <li>संधि के n- फलक पर घनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र के संधि के सिरों</li> </ul>		
विभव प्राचीर कहते हैं    18.  बीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन िकसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi c$ ; $F = 0$ , $3\pi a$ $\theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $3\pi a$ $F_E + F_B = 0$ $3\pi $		पर कोई विभवान्तर विकसित हो जाता है निरोधी विभव अथवा	1	
18.   बीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB\sin\theta$ $3\pi c$ : $F = 0$ , $\pi e = 0^\circ$ , $\theta = 180^\circ$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2}$				2
नीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB\sin\theta$ अतः $F = 0$ , जब $\theta = 0^\circ, \theta = 180^\circ$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2}$ जब $\overline{F}_E + \overline{F}_B = 0$ $\frac{1}{2}$ (i) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन $\frac{1}{2}$ (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन $\frac{1}{2}$ (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{\varepsilon}{12 + r}$ $\frac{\varepsilon}{1$	18	14014 MAIN PONT O		
लिए शर्त (a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $\frac{1}{2}$ $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0$ , $\pi = \theta = 0^\circ, \theta = 180^\circ$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2}$ $\pi = \frac{E}{B}$ 2  19 (a)  (i) सेल के बार्न परिकलन 1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 $I = \frac{E}{R+r}$ $0.25 = \frac{E}{12+r}$ (1) $1/2$ $1/2$	10.			
(a) जब केवल चुम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0,  \sigma = \theta = 0^{\circ}, \theta = 180^{\circ}$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $v = \frac{E}{B}$ 2  19 (a) $I = \frac{E}{R+r}$ $0.25 = \frac{E}{12+r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{E}{16+r} \qquad(2)$		नीचे दिए गए प्रकरणों में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होने के		
(b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0,  \pi^2 = \theta = 0^\circ, \theta = 180^\circ$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $v = \frac{E}{B}$ 2  19 (a)  (i) सेल के emf का परिकलन 1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (iii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (iv) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (iv) सेल के $\frac{E}{B}$		लिए शर्त		
(b) जब विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं और पुष्टिकरण $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0,  \pi^2 = \theta = 0^\circ, \theta = 180^\circ$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $v = \frac{E}{B}$ 2  19 (a)  (i) सेल के emf का परिकलन 1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (iii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (iv) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 (iv) सेल के $\frac{E}{B}$		(a) जब केवल च्रम्बकीय क्षेत्र है और पुष्टिकरण ½ +½		
(a) जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गित करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0$ , $3\pi = \theta = 0^\circ, \theta = 180^\circ$ $1/2$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $1/2$ $3\pi = \frac{E}{F_E} + F_B = 0$ $1/2$ $2$ $2$ $19$ (a)				
है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0$ , $\pi = \theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ $1/2$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $1/2$ $\pi = \frac{E}{B}$ $1/2$ $v = \frac{E}{B}$ $1/2$				
है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0$ , $\pi = \theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ $1/2$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $1/2$ $\pi = \frac{E}{B}$ $1/2$ $v = \frac{E}{B}$ $1/2$				
है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है   $F = qvB \sin\theta$ $3\pi : F = 0$ , $\pi = \theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$ $1/2$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $1/2$ $\pi = \frac{E}{B}$ $1/2$ $v = \frac{E}{B}$ $1/2$		(a) जब कोई इलेक्टॉन किसी चम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समान्तर गति करता		
$F = qvB sin\theta$		5		
$3\pi a : F = 0$ , $3\pi a : \theta = 0^\circ, \theta = 180^\circ$ (b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2}$ $3\pi a : \overline{F_E} + \overline{F_B} = 0$ $\frac{1}{2}$ $2$ $19 (a)$ (i) सेल के emf का परिकलन 1 (ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन 1 $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$ $0.25 = \frac{\varepsilon}{12+r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16+r} \qquad(2)$			1/2	
(b) बल तब शून्य होता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है । $\frac{1}{2}$ जब $\overline{F_E} + \overline{F_B} = 0$ $\frac{E}{B}$ $2$ $19$ (a)				
विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{E}{1}$ $\frac{E}{$		31ਰ: <sup>F = 0</sup> , जब θ = 0 ,θ = 180	1/2	
विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के क्रासित क्षेत्र में गित करता है   $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{E}{1}$ $\frac{E}{$		(b) बल तब शन्य होता है जब डलेक्टॉन नीचे दी गई शर्त के अनुसार		
जब $\overline{F_E} + \overline{F_B} = 0$ $v = \frac{E}{B}$ 2  19 (a) $(i) \ \dot{R}$ ले के emf का परिकलन $(ii) \ \dot{R}$ ले के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन $1$ $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$ $0.25 = \frac{\varepsilon}{12+r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16+r} \qquad(2)$		, "	1/2	
$v = \frac{E}{B}$ 19 (a) $(i) \ \dot{R} = \frac{\varepsilon}{R} + r$ $0.25 = \frac{\varepsilon}{12 + r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16 + r} \qquad(2)$ $\frac{1}{1/2} = \frac{\varepsilon}{1/2} + \frac{\varepsilon}{1/2} $			, -	
$B$ $(i) \ \ \dot{H} \ \ \dot{m} \ \dot{n} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		্ৰাৰ $F_E + F_B = 0$	1/2	
$B$ $(i) \ \ \dot{H} \ \ \dot{m} \ \dot{n} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		$V = \frac{E}{E}$		2
$(i) \ \ \dot{\text{R}} \ \dot{\text{R}} \ \dot{\text{e}} \ \text{emf} \ \ \dot{\text{a}} \ \text{परिकलन} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$				<u> </u>
(ii) सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिकलन $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$ $0.25 = \frac{\varepsilon}{12+r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16+r} \qquad(2)$ $1/2$	19 (a)			
$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$ $0.25 = \frac{\varepsilon}{12+r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16+r} \qquad(2)$				
$0.25 = \frac{\varepsilon}{12 + r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16 + r} \qquad(2)$		(11) सल के आंतारक प्रांतराध का पारकलन 1		
$0.25 = \frac{\varepsilon}{12 + r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16 + r} \qquad(2)$				
$0.25 = \frac{\varepsilon}{12 + r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16 + r} \qquad(2)$				
$0.25 = \frac{\varepsilon}{12 + r} \qquad(1)$ $0.2 = \frac{\varepsilon}{16 + r} \qquad(2)$		$I = \frac{\mathcal{E}}{\mathbf{R}}$		
$0.2 = \frac{\varepsilon}{16 + r} \qquad(2)$				
$\frac{1}{2}$		$0.25 = \frac{3}{12+r} \qquad(1)$	1/2	
$\frac{1}{2}$		$0.2 = \frac{\varepsilon}{}$ (2)		
समीकरण <sub>(1)</sub> तथा <sub>(2)</sub> को हल करने पर		16+ <i>r</i>	1/2	
		समीकरण <sub>(1)</sub> तथा <sub>(2)</sub> को हल करने पर		



	$r=4\Omega$	1/2	
	$\varepsilon = 4  \mathrm{V}$	1/2	
(b)	OR		
	विद्य् त क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना 1 ½		
	विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना		
	72		
	$Q_{1} = Q_{1} = Q_{1$		
	$\vec{E}_1 = \frac{kq_1}{r_1^2}(-\hat{i}) = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{(0.3)^2}(-\hat{i}) = 3 \times 10^5(-\hat{i}) \text{ NC}^{-1}$	1/2	
	$\vec{E}_{1} = \frac{kq_{1}}{r_{1}^{2}}(-\hat{i}) = \frac{9 \times 10^{9} \times 3 \times 10^{-6}}{(0.3)^{2}}(-\hat{i}) = 3 \times 10^{5}(-\hat{i}) \text{ NC}^{-1}$ $\vec{E}_{2} = \frac{kq_{2}}{r_{2}^{2}}(-\hat{j}) = \frac{9 \times 10^{9} \times 4 \times 10^{-6}}{(0.3)^{2}}(-\hat{j}) = 4 \times 10^{5}(-\hat{j}) \text{ NC}^{-1}$ $\vec{E} = \vec{E}_{1} + \vec{E}_{2}$	1/2	
	$E - E_1 + E_2$ $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ $E = 5 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$	1/2	
	$\tan \theta = \frac{4}{3}$ $\theta = \tan^{-1} \left( \frac{4}{3} \right)$ मूल बिंदु पर x अक्ष से झुकाव(तृतीय चतुर्थांश)	1/2	2
20.	(a) क्रांतिक कोण का परिकलन 1 (b) वृताकार चमकीले भाग की त्रिज्या का परिकलन 1		
	(a) $\sin i_c = \frac{1}{\mu}$ $\sin i_c = \frac{4}{5}$	1/2	
	$i_c = \sin^{-1}(\frac{4}{5})$ $or \ i_c = 53^o$	1/2	



		1/2	
	(b) $\sin i_c = \frac{r}{\sqrt{r^2 + h^2}}$ $\frac{r^2}{r^2 + h^2} = \left(\frac{4}{5}\right)^2$ $25r^2 = 16r^2 + 16h^2$ $9r^2 = 1600$ $r = \frac{40}{3} \text{ cm}$ A = 10 cm	1/2	2
21.	• हाइगेन्स के सिद्धांत का कथन 1 • आरेख खींचना 1 हाइगॅस के सिद्धांत के अनुसार, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत है और इन बिंदुओं से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाएँ तरंग की गित से सभी दिशाओं में फैलती हैं।तरंगाग्र से निर्गमन होने वाली इन तरंगिकाओं को प्रायः द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जाना जाता है और यदि हम इन सभी गोलों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्शक पृष्ठ खींचें तो हमें किसी बाद के समय पर तरंगाग्र की नयी स्थिति प्राप्त हो जाती है।  आपितत तरंगाग्र माध्यम 1	1	
	$v_1$ माध्यम $v_2$ $v_2$ अपवर्तित तरंगाग्र $v_2 > v_1$ SECTION- $v_2 > v_1$		2
22. (a)	$(i)  \text{ विद्युत क्षेत्र के विचरण का प्रकार और उसकी पुष्टि } \frac{1/2 + 1/2}{1/2 + 1/2}$ $(ii)  \text{ धाराधनत्व में विचरण का प्रकार और उसकी पुष्टि } \frac{1/2 + 1/2}{1/2 + 1/2}$ $(iii)  \text{इलेक्ट्रॉनों की गितिशीलता में विचरण का प्रकार और उसकी पुष्टि } \frac{1/2 + 1/2}{1/2 + 1/2}$ $(i)  E = \frac{I}{A} \rho  \text{ विद्युत क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी }  $ $(ii)  j = \frac{I}{A}  \text{, धारा धनत्व में वृद्धि हो जाएगी}  $	1/2+1/2 1/2+1/2	
	$\mu_{e}=rac{e au}{m}$ , गतिशीलता में कोई परिवर्तन नहीं होगा	1/2+1/2	

	अथवा		
(b)	बिंदुओं A, B और C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना 1+1+1		
	बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र ( $\vec{E}_A$ ) $\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$	1/2	
	$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (-\hat{\mathbf{i}}) + \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0} (\hat{\mathbf{i}})$	1/2	
	$ec{E}_A = rac{\sigma}{arepsilon_0}(\hat{\mathbf{i}})$ बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र $(ec{E}_B)$		
	$\vec{E}_B = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$	1/2	
	$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i} + \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i}$ $= \frac{2\sigma}{\varepsilon_0}\hat{i}$	1/2	
	बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ( $\vec{E}_c$ ) $\vec{E}_c = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ $= \sigma \hat{i} + \frac{3\sigma}{2} (\hat{i})$	1/2	
	$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i} + \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}(-\hat{i})$ $= \frac{\sigma}{\varepsilon_0}(-\hat{i})$	1/2	3
23.	निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा	1	
	$\frac{kq_1q_2}{r_{12}} = \frac{9 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-2}} = 20J$	1/2	
	$q_1 V_1 = q_1 \frac{A}{r_1} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6}{4 \times 10^{-2}} = 500 \text{J}$ $q_2 V_2 = q_2 \frac{A}{r_2} = \frac{20 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6}{5 \times 10^{-2}} = 800 \text{J}$	1/2 1/2	
	U = (20 + 500 + 800) J $U = 1320 J$	1/2	3
24.	कारण सहित व्याख्या 1+1+1		

	7	1	,
	$\left  \begin{array}{ccc} i_d & = & \varepsilon_0 \frac{d\varphi_E}{dt} \end{array} \right $	1	
	परिवर्ती विद्युत्फलक्स के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है।		
	संधारित्र को आवेशित करते समय विद्युत्फ्लक्स में परिवर्तन होता है।		
	संधारित्र के पूर्णतः आवेशित होने पर विद्युत्फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं		
	होता है । अतः विस्थापन धारा उत्पन्न नहींहोती है।		
	(b)माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति का चयन इस प्रकार		
	किया जाता है कि वह जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति से मिलान करे		
	ताकि तरंगों से जल के अणुओं को गतिज ऊर्जा का प्रभावी स्थानांतरण हो	1	
	और इनके तापमें वृद्धि हो जाए।		
	(c)अवरक्त तरंगों को ऊष्मीयतरंगेंक हे जाने का कारण यह है कि		
	अधिकांश पदार्थों में उपस्थित जल के अणु अवरक्त तरंगों को अवशोषित		3
	कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप उनकी तापीय गति में वृद्धि हो जाती है।	1	
25.			
	निम्नलिखित का परिकलन		
	(a) कार्यफलन 1 ½		
	(b) अधिकतम गतिज ऊर्जा 1 ½		
	(a) $\phi_0 = hv_0$	1/2	
	$=6.63\times10^{-34}\times1.0\times10^{15}$	1/2	
	$=6.63\times10^{-19}\mathrm{J}$		
	=4.14  eV (b) $V = -h(y, y)$	1/ <sub>2</sub> 1/ <sub>2</sub>	
	(b) $K.E{\text{max}} = h(v - v_0)$ = $6.63 \times 10^{-34} [3.0 \times 10^{15} - 1.0 \times 10^{15}]$	1/ <sub>2</sub>	
	$=6.63\times10^{-1} [3.0\times10^{-1}.0\times10^{-1}]$ $=13.26\times10^{-19} J$	1/	2
	=8.29eV	1/2	3
26.			
	पाश में प्रेरित emf का परिकलन 3		
	$\int_{ a } d\varphi$	1/2	
	$\left \varepsilon\right  = \frac{d\varphi}{dt}$		
	$=\frac{d}{dt}(BA\cos\theta)$		
	$=\frac{d}{dt}(\mu_0 nIAcos\theta)$		
	$\left \varepsilon\right  = \left(\mu_0 nA\cos\theta \cdot \frac{dI}{dt}\right)$	4	
		1	
	$ \varepsilon  = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times \frac{6}{\pi} \times 10^{-4} \times \cos 60^{\circ} \times \frac{5}{10^{-2}}$	1	
	$=6\times10^{-5} \text{ V}$	1/2	3



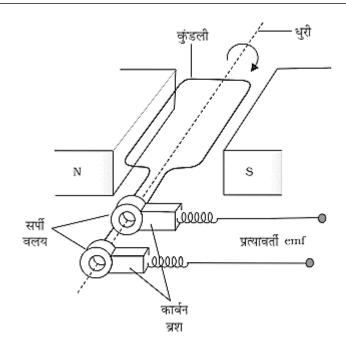
27.			
21.	(a) श्रेणी संयोजन में धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करना 1½		
	(b) धारा पर आवृत्ति का प्रभाव और उसका पुष्टिकरण 1½		
	(a) Current, $I = \frac{V}{Z} = \frac{V_0 \sin \omega t}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$	1/2	
	ac वोल्टता के समान स्रोत के लिए तीनों प्रकरणों में धारा समान है $R = X_L = X_C$	1/2	
	जब L, R तथा C श्रेणी में संयोजित हैं तब $Z=R$		
	ਤਰ: $I = \frac{V_0}{R} \sin \omega t$	1/2	
	(b) यदि स्रोत की आवृत्ति में वृद्धि की जाती है तो शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में धारा समान रहती है इस कारण यह है कि ओमी प्रतिरोध स्रोत की	1/2	
	आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है   दूसरी ओर स्रोत की आवृत्ति में वृद्धि करने पर शुद्ध प्रेररित्र परिपथ में		
	धारा घटती है क्योंकि $x_L \alpha v$		
	$I \propto \frac{1}{\nu}$ अतः $\nu$	1/2	
	स्रोत की आवृत्ति में वृद्धि करने पर शुद्ध संधारित्र परिपथ में धारा में वृद्धि होती है क्योंकि $x_c \alpha \frac{1}{v}$	1/2	2
	$I \propto v$	/2	3
28.			
	(a) तीव्रता वितरण वक्र खींचना 1 (b) दो लेंसों के संयोजन की क्षमता के लिए संबंध व्युत्पन्न करना 2		
	(a)		
		1	
	इसरी		

	(b)		
	(b)  A B D D D D D D D D D D D D D D D D D	1/2	
	पहले लेंस $A$ द्वारा प्रतिबिम्ब बनने के लिए $\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} \qquad(1)$		
		1/2	
	दूसरे लेंस B द्वारा प्रतिबिम्ब बनने के लिए $ \frac{1}{v} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_2} \qquad(2) $		
	समीकरण (1) और (2) का योग करने पर		
	$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}(3)$	1/2	
	यदि दो लेंसों के निकाय को किसी एकल लेंस के तुल्य माना जाए तो इस		
	तुल्य लेंस की फोकस दूरी $f$		
	$ \frac{1}{\mathbf{v}} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \qquad(4) $		
	समीकरण (3)और (4) से		
	$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$		
	परन्तु $P = \frac{1}{f}$		
	<b>ਮ</b> ਰ: $P = P_1 + P_2$	1/2	3
	SECTION - D		J
29.	(i) (A) B <sub>1</sub> only	1	
(a)	(ii) (B) A, C अथवा	1	
(b)	(C) उर्मिका के साथ एक दिशिक		
	(iii) (D) होल, इलेक्ट्रॉन	1	
	(iv) ( C ) 100 Hz	1	4
30.	(i) (B) $qd(\hat{i}+\hat{j})$	1	
	(ii) (C) 2 (iii) (A) 2.5 x 10 <sup>-5</sup> Nm	1	
(a)	1	1	
	(iv) (C) $\frac{1}{2}e^{Vr}$ OR		
(b)	(B) $5.0 \times 10^{-3} \text{Am}^2$		4
	SECTION - E		-
	1	1	

Get More Learning Materials Here :



- (i) a.c जिनत्रका नामांकित आरेख 1
   a.c जिनत्रकी कार्य विधि 1
   emf के लिए व्यंजक प्राप्त करना 1
- (ii) बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करना 2



1

a.c जिनत्र की कार्य विधि

जब किसी कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी नियत कोणीय चाल से घूर्णित किया जाता है तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में कोई emf प्रेरित होती है किसी क्षण t पर कुंडली से सम्बध फ्लक्स

1

 $\varphi_{B} = BA\cos\omega t$ 

$$\varepsilon = -N \frac{d\varphi_{\scriptscriptstyle B}}{dt}$$

 $\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$ 

1/2

 $\frac{1}{2}$ 

$$(ii) F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$$

पाश की भुजा MN पर बल

$$F_{1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 1 \times 10 \times 10^{-2}}{2\pi \times 20 \times 10^{-2}}$$

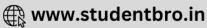
$$F_1 = 3 \times 10^{-7} \text{ N}$$

यह बल तार से दूर की ओर दिशिक है पाश की भुजा SP पर बल

$$F_2 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 1 \times 10 \times 10^{-2}}{2\pi \times 30 \times 10^{-2}}$$
  
 $F_2 = 2 \times 10^{-7} \text{ N}$ 

1/2

	यह बल तार की ओर दिशिक है	1/2	
	पाश पर नेट बल $F = F_1 - F_2 = 10^{-7} \text{ N}$	/2	
	पाश पर नेट बल तार से दूर की ओर दिशिक है   अथवा	1/2	
(b)	(i) विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का कथन ½		
	लेंज़ के नियम का उपयोग		
	स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करना 2		
	(ii) (1) कोणीय आवृत्ति परिकलित करना 1		
	(2) परिपथ की प्रतिबाधा परिकलित करना 1		
		1/2	
	चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है	/2	
	<ul> <li>लेंज़ के नियम का उपयोग- यह प्रेरित emf की ध्रुवता निर्धारित</li> </ul>	1/2	
	करता है	72	
	• अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, लम्बाई / तथा प्रति एकांक लम्बाई <i>n</i>		
	फेरों वाली किसी लम्बी परिनालिका पर विचार कीजिये यदि इस		
	परिनालिका से धारा/ प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर		
	चुंबकीय क्षेत्र		
	$B = \mu_0 nI$	1/2	
	परिनालिका से सम्बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स		
	$N\varphi_B = (nl)(\mu_0 nI)(A)$		
	$N\varphi_{B} = \mu_{0}n^{2}AlI$	1/2	
	स्वप्रेरकत्व		
	$L = \frac{N\varphi_{\scriptscriptstyle B}}{I}$	1/2	
	$L = \mu_0 n^2 A l$		
	यदि परिनालिका के भीतर आपेक्षिक चुंबक शीलता <sup><math>\mu_r</math></sup> का कोई पदार्थ	1/2	
	भरा है, तब		
	$L = \mu_r \mu_0 n^2 A l$		
	(i) (1) अनुनादीय कोणीय आवृत्ति		
	·	1/2	
	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$		
	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{50 \times 10^{-3} \times 80 \times 10^{-6}}} = 500 \text{ rad s}^{-1}$		
		1/2	
	(2) जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, तब		
	प्रतिबाधा = प्रतिरोध		



	Z = R	1/2	
	$Z = 20 \Omega$	1/2	5
32. (a)	(i) अभिदृशयक तथा अभिनेत्र लेंसों की अभिकल्पना करते समय विचार करने योग्य दो मुख्य बातें 1 दूरबीन की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करना 2 (i) परिकलन (1) प्रिज्म द्वारा विचलन कोण का परिकलन 1 (2) प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का परिकलन 1		
	दो विचारणीय मुख्य बातें		
	अभिदृश्यक के लिए		
	<ol> <li>अधिकतम व्यास</li> <li>अधिकतम फोकस दूरी</li> </ol>	1/2	
	नेत्रिका अभिनेत्र लेंस के लिए		
	1. लघु व्यास		
	2. लघु फोकस	1/2	
		1	
	किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता (m)प्रतिबिम्ब द्वारा नेत्र पर अंतरित		
	कोण $\beta$ तथा बिम्ब द्वारा नेत्र पर ( अथवा लेंस पर ) आंतरिक कोण $\alpha$ के		
	अनुपात के बराबर होती है   $m \approx \frac{\beta}{\alpha} \approx \frac{h}{f_e} \cdot \frac{f_0}{h} = \frac{f_0}{f_e}$	1	
	(ii) $i+e=D+A$ at $D=D_m$ , $i=e$		
	$2i = D_m + A$ $2 \times 45 = D_m + 60^0$ $D_m = 30^0$	1	

$\mu = \frac{\sin\left(\frac{60^{\circ} + 30^{\circ}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^{\circ}}{2}\right)} = \sqrt{2}$ (b) अथवा $(i) \ \text{एकल झिरी के कारण प्राप्त विवर्तन पैटर्न का प्रेक्षण करने के लिए कार्यकलाप का विवरण 2 (ii) द्रव का अपवर्तनांक 3 (i) \ \text{दो रेजर ब्लेडों को इस प्रकार पकड़ते हैं की उनके किनारे समान्तर हों और दोनों के बीच एक संकीण झिरी बने   झिरी को फिलामेंट के समान्तर ठीक सामने रखकर झिरी का अवलोकन करते हैं   कुछ समायोजन करने पर दीप्त और अदीप्त बैण्डों का पैटर्न दिखाई देता है   (ii) \frac{1}{f} = (\mu - 1) \left[\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_2}\right]  3तल लेंस की फोकस दूरी , f_1 = 30  \text{cm} \frac{1}{30} = (1.5 - 1) \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{(-R)}\right] R = 30  \text{cm} संयोजन की फोकस दूरी , f = 45  \text{cm} द्रव के समयावतल लेंस की फोकस दूरी . \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1} \frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30} f_2 = -90  \text{cm} लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करने पर \frac{1}{-90} = (\mu_i - 1) \left[\frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty}\right] \mu_i = \frac{4}{3}$		$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$		
(b) अथवा  (i) एकल झिरी के कारण प्राप्त विवर्तन पैटर्न का प्रेक्षण करने के लिए कार्यकलाप का विवरण 2 (ii) द्रव का अपवर्तनांक 3  (i) दो रेजर ब्लेडों को इस प्रकार पकड़ते हैं की उनके किनारे समान्तर हों और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिरी बने   झिरी को फिलामेंट के समान्तर ठीक सामने रखकर झिरी का अवलोकन करते हैं   कुछ समायोजन करने पर दीप्त और अदीप्त बैण्डों का पैटर्न दिखाई देता है   (ii) $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$ उत्तल लेंस की फोकस दूरी , $f_1 = 30  \mathrm{cm}$ $\frac{1}{30} = (1.5 - 1) \left[ \frac{1}{R} - \frac{1}{(-R)} \right]$ $R = 30  \mathrm{cm}$ संयोजन की फोकस दूरी , $f = 45  \mathrm{cm}$ द्रव के समयावतल लेंस की फोकस दूरी . $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1}$ $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30}$ $f_2 = -90  \mathrm{cm}$ लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करने पर $\frac{1}{-90} = (\mu_l - 1) \left[ \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right]$ $\mu_l = \frac{4}{-}$		$\mu = \frac{\sin\left(\frac{60^0 + 30^0}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^0}{2}\right)}$	1	
(i) एकल झिरी के कारण प्राप्त विवर्तन पैटर्न का प्रेक्षण करने के लिए कार्यकलाप का विवरण 2 (ii) द्रव का अपवर्तनांक 3		$=\sqrt{2}$		
लिए कार्यकलाप का विवरण 2 (ii) द्रव का अपवर्तनांक 3 $2$ (i) दो रेजर ब्लेडों को इस प्रकार पकड़ते हैं की उनके किनारे समान्तर हों और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिरी बने   झिरी को फिलामेंट के समान्तर ठीक सामने रखकर झिरी का अवलोकन करते हैं   कुछ समायोजन करने पर दीप्त और अदीप्त बैण्डों का पैटर्न दिखाई देता है   (ii) $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left[ \frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_2} \right]$ 3तत लेंस की फोकस दूरी , $f_1 = 30\mathrm{cm}$ $\frac{1}{30} = (1.5 - 1) \left[ \frac{1}{R} - \frac{1}{(-R)} \right]$ $R = 30\mathrm{cm}$ संयोजन की फोकस दूरी , $f = 45\mathrm{cm}$ दव के समयावतल लेंस की फोकस दूरी . $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_i}$ $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30}$ $\frac{1}{f_2} = -90\mathrm{cm}$ लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करने पर $\frac{1}{-90} = (\mu_i - 1) \left[ \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right]$ $\mu_i = \frac{4}{-}$	(b)	अथवा		
हों और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिरी बने   झिरी को फिलामेंट के समान्तर ठीक सामने रखकर झिरी का अवलोकन करते हैं   कुछ समायोजन करने पर दीप्त और अदीप्त बैण्डों का पैटर्न दिखाई देता है   $ (ii) \ \frac{1}{f} = (\mu - 1) \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] $ 3तल लेंस की फोकस दूरी , $f_1 = 30  \mathrm{cm}$ $ \frac{1}{30} = (1.5 - 1) \left[ \frac{1}{R} - \frac{1}{(-R)} \right] $ $R = 30  \mathrm{cm}$ संयोजन की फोकस दूरी , $f = 45  \mathrm{cm}$ दव के समयावतल लेंस की फोकस दूरी . $ \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1} $ $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30} $ $\frac{1}{f_2} = -90  \mathrm{cm}$ लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करने पर $ \frac{1}{-90} = (\mu_l - 1) \left[ \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right] $ $\frac{1}{42} = \frac{4}{4} $		लिए कार्यकलाप का विवरण 2		
देता है   $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$ 3ताल लेंस की फोकस दूरी , $f_1 = 30  \mathrm{cm}$ $\frac{1}{30} = (1.5 - 1) \left[ \frac{1}{R} - \frac{1}{(-R)} \right]$ $R = 30  \mathrm{cm}$		हों और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिरी बने   झिरी को फिलामेंट के समान्तर ठीक सामने रखकर झिरी का अवलोकन करते हैं	2	
उत्तल लेंस की फोकस दूरी , $f_1=30\mathrm{cm}$ $\frac{1}{30}=(1.5-1)\left[\frac{1}{R}-\frac{1}{(-R)}\right]$ $R=30\mathrm{cm}$ $\frac{1}{20}$ संयोजन की फोकस दूरी , $f=45\mathrm{cm}$ $\frac{1}{20}$		देता है	1/2	
संयोजन की फोकस दूरी , $f=45\mathrm{cm}$		उत्तल लेंस की फोकस दूरी , $f_1=30\mathrm{cm}$	/2	
$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1}$ $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30}$ $f_2 = -90 \text{ cm}$ लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करने पर $\frac{1}{-90} = (\mu_l - 1) \left[ \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right]$ $\mu_L = \frac{4}{f_2}$		संयोजन की फोकस दूरी , f = 45 cm	1/2	
लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करने पर $\frac{1}{-90} = (\mu_l - 1) \left[ \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right]$ $\mu_l = \frac{4}{2}$		$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1}$ $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30}$	1/2	
$\frac{1}{-90} = (\mu_l - 1) \left[ \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right]$ $\mu_k = \frac{4}{-30}$			1/2	
$u_{ij} = \frac{4}{3}$		$ \frac{1}{-90} = (\mu_t - 1) \left\lceil \frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty} \right\rceil $		
		$\mu_l = \frac{4}{3}$	1/2	5

12

3. (a)		
, ,	(ii) द्रव्यतरंगों की परिभाषा 1	
	देब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करना 2	
	(iii) (1) प्रकाशपुंजमेंफोटॉनकीऊर्जापरिकलितकरना 1	
	(2) प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या परिकलित 1	
(i)	गतिशील पिंड से सम्बद्ध तरंग को द्रव्यतरंग कहते हैं	
` '	द्रव्यमान m और आवेश q के कण द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में	1
	ऊर्जा की लिब्ध	
$\frac{1}{2}n$	$av^2 = qV$	1/2
_	$(v)^2 = 2qVm$	
	$=\sqrt{2mqV}$	1/2
	ग्नी संबंध के अनुसार	
	$\frac{h}{h}$	1/2
	mV	
λ =	$=\frac{h}{\sqrt{2mqV}}$	1/2
(i)	(1)	
	$E = hv$ = $6.63 \times 10^{-34} \times 5 \times 10^{14}$	1/2
	$=3.315\times10^{-19}$ J	1/2
	(2)	
	Р	
	$n = \frac{1}{E}$	1/2
	2 215 × 10 <sup>-3</sup>	
	$=\frac{3.315\times10^{-3}}{3.315\times10^{-19}}=10^{16}\mathrm{s}^{-1}$	1/2
		/2
	अथवा	
(b)	, , , , , ,	
	(i) बोर के अभिगृहीत ½ x 3	
	(ii) हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजकप्राप्त करना	
	i) बधनऊजी प्रतिन्यूक्लियाँन का परिकलन 1 ½	

(1)	बोर के अभिगृहीत		
(i)	किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण		
	ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है।	1/2	
(ii)	इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण		
	करता है जिन के लिए कोणीय संवेगका मान h/2 का पूर्णांक गुणज		
	होता है । जहाँ h प्लांक नियतांक (= 6.6 × 10 <sup>-34</sup> Js) । अतः	1/2	
	परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग (L) क्वाटित है ।	, -	
(iii)	कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकिरणी कक्षा से		
	दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है । जब यह	1/2	
	ऐसा करता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक		
	एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है।		
	हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा		
E = -	$\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n} - \cdots - (1)$	1/2	
	$8\pi\varepsilon_0 r_n$ (1)		
	<sub>n,</sub> n <sup>वीं</sup> कक्षा की त्रिज्या है		
$r_n = \frac{n}{2}$	$\frac{^{2}h^{2}\varepsilon_{0}}{\tau me^{^{2}}} \qquad (2)$	1/2	
	रण (2) का मान समीकरण (1) में रखने पर		
(IVIII4)	(2) 4/1 0/10/1 (10/14/(-) (1) 0/1 (Go) 4(		
F -	$-\frac{me^4}{8n^2\varepsilon_0^2h^2}$	1	
	$8n^2\varepsilon_0^2h^2$		
(ii)	$\Delta m = \left[6m(\frac{1}{n}) + 6m(\frac{1}{n})\right] + m(\frac{12}{n})$	1/2	
(1)द्रव	यमान क्षति , $\Delta m = \left[6m\binom{1}{0}n + 6m\binom{1}{1}H\right] - m\binom{12}{6}C$		
	$\Delta m = (6 \times 1.008665 + 6 \times 1.007825) - 12.000000$ $\Delta m = 0.09894 \text{ u}$	1/2	
	$B.E. = \Delta m \times 931.5 \text{MeV}$		
	=92.16MeV		
<u> </u>	ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन $E_{bn}=rac{E_{b}}{A}$		
षधन	জনা সাম দ্বাপেলাল <i>™ A</i> 92.16		
	$=\frac{92.16}{12}$		
	=7.68MeV	1/2	

# Marking Scheme Strictly Confidential

### (For Internal and Restricted use only) Senior School Certificate Examination, 2024

# SUBJECT NAME PHYSICS [PAPER CODE 55/S/3]

1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct
	assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems
	which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To
	avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand
	the spot evaluation guidelines carefully.
2	"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the
_	examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to
	public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the
	life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone,
	publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action
	under various rules of the Board and IPC."
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not
	be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme
	should be strictly adhered to and religiously followed. <b>However, while evaluating, answers</b>
	which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be
	assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-
	X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given
	answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is
	enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers
	These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The
	students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should
	be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator
	on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given
	in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration
	and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after
	ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark( $\sqrt{\ }$ ) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be
	marked. Evaluators will not put right $(\checkmark)$ while evaluating which gives an impression that
	answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which
	evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks
	awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-
	hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and
	encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks
	should be retained and the other answer scored out with a note "Extra Question".
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only
	once.
11	$\Delta$ full scale of marks 0.70 (evample 0 to $\frac{90}{70} \frac{60}{50} \frac{40}{20}$ marks as given in Overtice
11	A full scale of marks <u>0-70</u> (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question
12	Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours
	every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per





	day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced					
	syllabus and number of questions in question paper.					
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the					
	Examiner in the past:-					
	<ul> <li>Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.</li> </ul>					
	Giving more marks for an answer than assigned to it.					
	Wrong totaling of marks awarded on an answer.					
	• Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.					
	Wrong question wise totaling on the title page.					
	Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.					
	Wrong grand total.					
	Marks in words and figures not tallying/not same.					
	Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.					
	• Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is					
	correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for					
	incorrect answer.)					
	Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.					
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be					
	marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.					
15	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error					
	detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the					
	evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned,					
	it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.					
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for					
	spot Evaluation" before starting the actual evaluation.					
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to					
	the title page, correctly totaled and written in figures and words.					
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment					
	of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head					
	Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out					
	strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.					



	MARKING SCHEME: PHYSICS(042)  Code: 55/S/3		
Q. No.	VALUE POINTS/EXPECTED ANSWERS	Marks	Total Marks
	SECTION A		
1.	(A) The wave is propagating along +x-axis.	1	1
2.	(D) 45°	1	1
3.	$(A) M < (A-Z) m_n + Zm_p$	1	1
4.	$(D) \frac{B^2 l^2 v}{R}$	1	1
5.	(B) Behave like a paramagnetic material	1	1
6.	(D) first real and then virtual.	1	1
7.	(A) $30^{\circ}$	1	1
8.	(D) 4	1	1
9.	(C) The number of alpha particles undergoing head on collision is small.	1	1
10.	(C) Current Intensity	1	1
11.	(B) increase the number of holes in the valence bond.	1	1
12.	$(C)\frac{7}{3}V,\frac{2}{3}\Omega$	1	1
13.	(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion(A).	1	1
14.	(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion(A).	1	1
15.	(D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.	1	1
16.	(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion(A).	1	1
17.	SECTION B		
	Explanation and formation of terms Depletion layers Potential barrier  During the formation of p-n junction due to the concentration gradient holes diffuse from p- side to n-side leaving behind an immobile ionized acceptor (negative charge), hence forming a layer of negative charge (negative space-charge region) on p- side.  Similarly, a layer of positive charge is developed on the n-side of the junction (positive space-charge region). This space – charge region on either side of the junction together is known as depletion layer.  Due to the positive space- charge region on the n-side of the junction & negative space – charge region on the p- side of the junction a potential difference is developed across the junction of the two regions, which is called potential barrier.	1	2

10			1
18.	Condition for experiencing no force on electron in  (a) Only magnetic field and justification  (b) In electric and magnetic field both and justification  1/2 +1/2		
	(a) Force on an electron in magnetic field is zero when it moves parallel/antiparallel to the direction of magnetic field. $F = qvB \sin\theta$	1/2	
	Hence $F = 0$ , when $\theta = 0^{\circ}$ , $\theta = 180^{\circ}$	1/2	
	(b) Force is zero when electron moves in a crossed field of electric and magnetic fields with condition.	1/2	
	$\vec{F}_E + \vec{F}_B = 0$ $v = \frac{E}{I}$	1/2	2
19 (a)	B		2
17 (a)	(i) Calculating e.m.f of cell 1 (ii) Calculating internal resistance of cell 1		
	$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$ $0.25 = \frac{\varepsilon}{12+r}$ $(1)$	1/2	
	$0.2 = \frac{\varepsilon}{16+r} \qquad(2)$	1/2	
	On solving eq (1) and (2) $r = 4\Omega$ $\varepsilon = 4 \text{ V}$	1/ <sub>2</sub> 1/ <sub>2</sub>	
	OR		
(b)	Finding the magnitude of electric field 1½ Finding the direction of electric field ½		
	$(0,0.3m)$ $q_2 = 4\mu C$		
	$ \begin{array}{c c} \hline E_1 & (0,0) & q_1 = 5 \text{MC} \\ \hline \theta & (0.3\text{m},0) \\ \hline E_2 & \hline \end{array} $		
	$\vec{E}_1 = \frac{kq_1}{r_1^2}(-\hat{i}) = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{(0.3)^2}(-\hat{i}) = 3 \times 10^5(-\hat{i}) \text{ NC}^{-1}$	1/2	
	$\vec{E}_2 = \frac{kq_2}{r_2^2}(-\hat{j}) = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}}{(0.3)^2}(-\hat{j}) = 4 \times 10^5(-\hat{j}) \text{ NC}^{-1}$	1/2	



	$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ $E = 5 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$	1/2	
	$\tan \theta = \frac{4}{3}$ $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{4}{3}\right)$ inclination with respect to the x-axis (in III quadrant).	1/2	2
20.	(a) Calculation of critical angle 1 (b) Calculation of radius of circular light patch 1		
	(a) $\sin i_c = \frac{1}{\mu}$ $\sin i_c = \frac{4}{5} \qquad (\because \mu = 1.25 = \frac{5}{4})$	1/2	
	$i_c = \sin^{-1}(\frac{4}{5})$ $or \ i_c = 53^\circ$	1/2	
	(b) $\sin i_c = \frac{r}{\sqrt{r^2 + h^2}}$ $\frac{r^2}{r^2 + h^2} = \left(\frac{4}{5}\right)^2$ $25r^2 = 16r^2 + 16h^2$ $9r^2 - 1600$ $h = 100$	1/2	
	$r = \frac{40}{3} \text{ cm}$	1/2	2
21.	Stating Huygens Principle     Diagram     Diagram     Diagram     Huygens Principle:  Each point of the wavefront is the source of a secondary disturbance and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets and if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time.	1	
	Incident wavefront  Medium 1 $v_1$ $v_2$ $v_2$ $v_2$ Refracted wavefront	1	2

	SECTION- C		
22. (a)	(i) Variation of electric field and justification $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (ii) Variation of current density and justification $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ (iii) Variation of mobility of electrons and justification $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ With the decrease in area of cross-section.		
	(i) $E = \frac{I}{A} \rho$ , electric field increases	1/2+1/2	
	$j = \frac{I}{A}$ , current density increases	1/2+1/2	
	(iii) $\mu_e = \frac{e\tau}{m}$ , mobility remains same OR	1/2+1/2	
(b)	Finding the net electric field (E) at points A,B & C 1+1+1		
	Electric field at $A(\vec{E}_A)$		
	$\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ $\sigma \in \hat{S}_A + 3\sigma \in \hat{S}_A$	1/2	
	$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (-\hat{\mathbf{i}}) + \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0} (\hat{\mathbf{i}})$ $\vec{E}_A = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} (\hat{\mathbf{i}})$	1/2	
	Electric field at B $(\vec{E}_B)$		
	$\vec{E}_B = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$	1/	
	$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i}+\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i}$	1/2	
	$=\frac{2\sigma}{\varepsilon_0}\hat{i}$	1/2	
	Electric field at C ( $\vec{E}_C$ )		
	$ec{E}_c = ec{E}_1 + ec{E}_2$ $\sigma : 3\sigma : 3\sigma$	1/2	
	$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i}+\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}(-\hat{i})$	1/2	
	$=rac{\sigma}{arepsilon_0}(-\hat{i})$		3
23.	Calculating electrostatic potential energy of the system 3		
	Electrostatic potential energy of the system:		
	$U = \frac{kq_1q_2}{r_{12}} + q_1V_1 + q_2V_2$	1	
	$U = \frac{kq_1q_2}{r_{12}} + q_1V_1 + q_2V_2$ $\frac{kq_1q_2}{r_{12}} = \frac{9 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-2}} = 20J$	1/2	



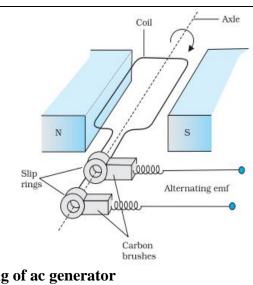
			1
	$q_1 V_1 = q_1 \frac{A}{r_1} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6}{4 \times 10^{-2}} = 500$ J	1/2	
	$q_2 V_2 = q_2 \frac{A}{r_2} = \frac{20 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6}{5 \times 10^{-2}} = 800$ J	1/2	
	U = (20 + 500 + 800) J $U = 1320 J$	1/2	3
24.	Explanation of (a),(b) and (c) with reason 1+1+1		
	<ul> <li>i<sub>d</sub> = ε<sub>0</sub> dφ<sub>E</sub>/dt</li> <li>Displacement current is due to changing electric flux.</li> <li>During charging of capacitor, there is change in electric flux.</li> <li>When fully charged the electric field does not change hence electric flux also does not change. Hence no displacement current.</li> <li>(b) The frequency of the microwaves is selected to match the resonant frequency of water molecules so that energy from the waves is</li> </ul>	1	
	transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules.  (c) Infrared waves are also known as heat waves, because water molecules present in most materials readily absorbs infrared waves and their thermal motion increases and heat up.	1	3
25.	Calculating		
	(a) Work Function 1 ½ (b) maximum Kinetic energy 1 ½		
	(a) $\phi_0 = hv_0$ = 6.63×10 <sup>-34</sup> ×1.0×10 <sup>15</sup>	1/2 1/2	
	$=6.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ $=4.14 \text{ eV}$	1/ <sub>2</sub> 1/ <sub>2</sub>	
	(b) $K.E{\text{max}} = h(v - v_0)$ = $6.63 \times 10^{-34} [3.0 \times 10^{15} - 1.0 \times 10^{15}]$ = $13.26 \times 10^{-19} \text{ J}$	1/2	
	$= 13.26 \times 10  \text{J}$ $= 8.29  eV$	1/2	3
26.	Calculation of e.m.f induced in the loop 3		
	E.m.f induced in the circular loop: axis $\left \varepsilon\right  = \frac{d\varphi}{dt}$	1/2	
	$dt = \frac{d}{dt}(BA\cos\theta)$ $= \frac{d}{dt}(\mu_0 nIA\cos\theta)$		
	$=\frac{d}{dt}(\mu_0 nIAcos\theta)$	1	



	$ c  = \left( u  n A \cos \theta  \frac{dI}{dI} \right)$	1	
	$\left \varepsilon\right  = \left(\mu_0 nA \cos\theta \cdot \frac{dI}{dt}\right)$ $\left \varepsilon\right  = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times \frac{6}{\pi} \times 10^{-4} \times \cos 60^{\circ} \times \frac{5}{10^{-2}}$		
	$ \varepsilon  = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times \frac{6}{\pi} \times 10^{-4} \times \cos 60^{\circ} \times \frac{5}{10^{-2}}$		
	$=6\times10^{-5} \text{ V}$	1/2	3
27.	(a) Finding instantaneous value of current in series combination 1½ (b) Effect of frequency on current and justification 1½		
	(a) Current, $I = \frac{V}{Z} = \frac{V_0 \sin \omega t}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$		
	For the same source of ac voltage and current is same in all the three cases. $R = X_L = X_C$ When L. B and C are ising d in series	1/2	
	When L, R and C are joined in series $Z = R$	1/2	
	Hence, Instantaneous current, $I = \frac{V_0}{R} \sin \omega t$	1/2	
	(b) If frequency of the source is increased, current in pure resistive circuit will remain same as ohmic resistance is independent of frequency.	1/2	
	Current in pure inductive circuit will decrease as $X_L \propto v$		
	so, $I \propto \frac{1}{v}$	1/2	
	Current in pure capacitive circuit will increase as		
20	$I \propto v$	1/2	3
28.	(a) Draw the intensity distributions current 1 (b) Deriving the relative for power of combination of two lenses 2		
	(a)  Incoming wave (a) Viewing screen	1	
	(b)  A B  D II	1/2	
	For the image formed by first lens A, we get		



	$\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1}(1)$	1/2	
	For the image formed by the second lens B, we get		
	$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_2} \qquad(2)$	1/2	
	Adding eqs (1) and (2) we get  1 1 1 1		
	$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \qquad(3)$		
	If the two lens system is regarded as equivalent to a single lens of focal		
	length f, we have		
	$\frac{1}{\mathbf{v}} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \qquad(4)$		
	From eqs (3) & (4)		
	$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$		
	$f$ $f_1$ $f_2$		
	$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$ As, $P = \frac{1}{f}$		
	Hence, $P = P_1 + P_2$	1/2	3
	SECTION - D		
29.	(A) B <sub>1</sub> only	1	
(a)	(ii) (B) A, C	1	
	OR		
(b)	(C) unidirectional with ripple		
	(iii) (D) holes, electrons	1	
	(iv)(C)100 Hz	1	4
30.	(i) (B) $qd(\hat{i}+\hat{j})$	1	
	(ii) (C) 2	1	
	(iii) (A) 2.5 x 10 <sup>-5</sup> Nm	1	
(a)	$\frac{1}{-e vr}$	1	
	(iv) (C) $\frac{1}{2}e^{Vr}$ OR		
(b)	$5.0 \times 10^{-3} \mathrm{Am}^2$		A
, ,	(B) SECTION - E		4
21 (a)			
31. (a)	(i) Labelled diagram of ac generator 1		
	Working of ac generator 1 Obtaining expression for e.m.f 1		
	(ii) Finding magnitude of force and direction 2		
	I		



#### Working of ac generator

When coil is rotated in a uniform magnetic field with a constant angular speed ω, magnetic flux through it changes. As a result, an e.m.f is induced in the coil.

Flux linked with the coil at any instant 't' is

$$\varphi_{B} = BA\cos\omega t$$

$$\varepsilon = -N\frac{d\varphi_{B}}{dt}$$

$$\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$$

(ii) 
$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$$

force on arm MN of the loop

$$F_{1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 1 \times 10 \times 10^{-2}}{2\pi \times 20 \times 10^{-2}}$$

$$F_1 = 3 \times 10^{-7} \text{ N}$$

Force is directed away from the wire

Force on arm SP of the loop

$$F_2 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 1 \times 10 \times 10^{-2}}{2\pi \times 30 \times 10^{-2}}$$

$$F_2 = 2 \times 10^{-7} \text{ N}$$

Force directed towards the wire

Net force on the loop

$$F = F_1 - F_2 = 10^{-7} \text{ N}$$

Net force on the loop is away from the wire.

(b)

#### OR

- (i) Statement of Faraday's law of electromagnetic induction  $\frac{1}{2}$ Utility of Lenz's law 1/2 Obtaining expression for self inductance 2 (ii) (1) calculating angular frequency 1 (2) calculating impedance of the circuit
- (i) The magnitude of induced e.m.f in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit

Utility of Lenz's law

It give polarity of the induced e.m.f.



 $\frac{1}{2}$ 

1

1

 $\frac{1}{2}$ 

1/2

1/2

 $\frac{1}{2}$ 

1/2

 $\frac{1}{2}$ 

Total magnetic flux linked with the solenoid is $N\varphi_{B} = (nl)(\mu_{0}nI)(A)$	/2	
$B = \mu_0 nI$ Total magnetic flux linked with the solenoid is $N\varphi_B = (nl)(\mu_0 nI)(A)$ $N\varphi_B = \mu_0 n^2 AlI$ Self inductance		
$N\varphi_B = \mu_0 n^2 A I I$ Self inductance	/2	
$L = \frac{N\varphi_{\scriptscriptstyle B}}{I}$		
	/2	
If solenoid is filled with a material of relative permeability $\mu_r$ , then $L = \mu_r \mu_0 n^2 A l$	/2	
(ii) (1) Resonant angular frequency is $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	/2	
•	/2	
(2) When frequency of supply is equal to natural frequency of the circuit	/2	
7 20 0	/2	5
(i) Two main considerations for designing objective and eye piece 1 Obtaining expression for magnifying power of telescope 2 (ii) Calculating (1) Angle of deviation 1 (2) Refractive index 1		
Two main considerations Objective should have  1. Larger diameter 2. Larger focal length Eye piece should have	/2	
1. Smaller diameter	/2	
Objective Eyepiece $H - J_G -$	1	
Magnifying power of telescope Magnifying power is the ratio of the angle $\beta$ subtended at the eye by the final images to the angle $\alpha$ which the object subtends at the lens or eye		



	$m \approx \frac{\beta}{\alpha} \approx \frac{h}{f_e} \cdot \frac{f_0}{h} = \frac{f_0}{f_e}$	1	
	(ii) $i+e = D+A$		
	at $D = D_m$ , $i = e$		
	$2i = D_m + A$		
	$2 \times 45 = D_m + 60^0$		
	$D_m = 30^0$	1	
	$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$		
	$\mu = \frac{\sin\left(\frac{60^0 + 30^0}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^0}{2}\right)}$		
	$\mu = \frac{1}{\sin\left(\frac{60^{\circ}}{10^{\circ}}\right)}$		
		1	
	$=\sqrt{2}$	-	
(b)	OR		
	(i) Describing activity to observe diffraction pattern		
	due to a single slit  (ii) Finding refractive index of the liquid  3		
	(ii) I maing terractive index of the fiquid		
	(i) We hold two razor blades in such a way that their edges are parallel and with a narrow slit in between. Keep the slit parallel to the filament of electric bulb, right in front of the eye.  A diffraction is seen with its bright and dark bands.	2	
	(ii) $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$	1/2	
	Focal length of convex lens, $f_1 = 30 \mathrm{cm}$		
	$\frac{1}{30} = (1.5 - 1) \left[ \frac{1}{R} - \frac{1}{(-R)} \right]$	1/2	
	$R = 30 \mathrm{cm}$	1/2	
	focal length of combination, $f = 45 \text{ cm}$		
	focal length of plane concave lens of liquid.  1 1 1		
	$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1}$	1/2	
	$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{45} - \frac{1}{30}$		
	$f_2 = 45 - 30$ $f_2 = -90 \text{cm}$		
	Using lens maker's formula	1/2	
	$\frac{1}{-90} = \left(\mu_l - 1\right) \left[\frac{1}{-30} - \frac{1}{\infty}\right]$		
i .	ı		

	$\mu_l = \frac{4}{3}$	1/2	5
33. (a)	(i) Defining matter waves  Obtaining expression for de- Broglie wavelength  (ii) (1) Calculating energy of photon  (2) Calculating number of photons per second		
	(i) Wave associated with a mass in motion is called matter wave.  Particle of mass m and charge q gains energy in the form of kinetic energy.	1	
	$\frac{1}{2}mv^2 = qV$ $(mv)^2 = 2qVm$	1/2	
	$mv = \sqrt{2mqV}$	1/2	
	Accordingly to de-Broglie relation $\lambda = \frac{h}{mv}$	1/2	
	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$	1/2	
	(ii) (1) $E = hv$	1/2	
	$= 6.63 \times 10^{-34} \times 5 \times 10^{14}$ $= 3.315 \times 10^{-19} \text{ J}$	1/2	
	$(2)$ $n = \frac{P}{E}$	1/2	
	$= \frac{3.315 \times 10^{-3}}{3.315 \times 10^{-19}} = 10^{16} \mathrm{s}^{-1}$ OR	1/2	
(b)			
	(i) Bohr's postulates 1/2 x 3 Deriving expression for energy of electron in nth orbit of hydrogen atom 2 (ii) Calculating Binding Energy per nucleon 1 1/2		
	(i) <b>Bohr's Postulates</b> (a) Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy,  (b) Bohr's second postulate defines these stable orbits. This postulate	1/2	
	states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of $h/2 \pi$ where h is the Planck's constant.	1/2	



(c) Bohr's third postulate states that an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy	1/2	
difference between the initial and final states.		
Derivation		
Total energy of electron in the stationary state of hydrogen atoms is		
$E = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n}$	1/2	
Where $r_n$ is radius of $n^{th}$ orbit $r_n = \frac{n^2 h^2 \varepsilon_0}{\pi m e^2} - \dots (2)$		
$\frac{r_n - \pi me^2}{\pi me^2}$ Substituting eq (2) in eq (1)	1/2	
$E_n = -\frac{me^4}{8n^2 \varepsilon_0^2 h^2}$	1	
(ii) $\operatorname{Mass defect}, \Delta m = \left[6m\binom{1}{0}n\right] + 6m\binom{1}{1}H$ $-m\binom{12}{6}C$	1/2	
$\Delta m = (6 \times 1.008665 + 6 \times 1.007825) - 12.000000$ $\Delta m = 0.09894 \text{ u}$		
$B.E. = \Delta m \times 931.5 \mathrm{MeV}$	1/2	
= 92.16MeV		
Binding energy per nucleon, $E_{bn} = \frac{E_b}{A}$		
$=\frac{92.16}{12}$		
_ 12		
=7.68MeV	1/2	5

